



アニュアルレポート 2012

Annual Report 2012

2012年3月期

50 Years

東京エレクトロンは2012年11月11日に
創立50年目を迎えます。

目次

ハイライト

- 2 連結財務ハイライト

トップメッセージ

- 3 ステークホルダーの皆様へ
- 4 社長インタビュー

セグメント情報

- 7 東京エレクトロンの事業概要
- 8 部門別営業概況および事業展望

特集

- 9 特集 1
- 11 特集 2

コーポレート・ガバナンス

- 12 コーポレート・ガバナンス
- 15 取締役・監査役および執行役員

環境・社会活動

- 16 環境・健康・安全に対する取り組み

研究開発／知的財産

- 17 研究開発
- 18 知的財産

財務セクション

- 19 財務概況
- 23 11年間の主要財務データ
- 24 連結貸借対照表
- 25 連結損益計算書
- 25 連結包括利益計算書
- 26 連結株主資本等変動計算書
- 26 連結キャッシュ・フロー計算書
- 27 連結財務諸表注記
- 37 独立監査人の監査報告書

会社情報

- 38 東京エレクトロングループ
- 39 株式情報

将来見通しに関する注意事項

このアニュアルレポートで述べられている東京エレクトロンの将来の業績予測、経営戦略、確信等は、現時点で入手可能な情報に鑑みてなされた当社の判断に基づくものであり、これらの将来見通しの記述には、既知または未知のリスク、および不確実性等の要因が内在しています。従いまして、実際の業績、成果はここに述べられている見通しとは大きく異なる可能性があることをご承知おさください。

東京エレクトロンの将来見通しに直接的・間接的に影響を与える要因としては次のようなものがあります。

- 国内外の経済情勢、消費動向、為替相場の大幅な変動
 - 半導体/FPD/PV市況の変化
 - 半導体メーカー、FPDメーカー、太陽電池メーカー、電子機器メーカー等の東京エレクトロンの顧客が生産または提供する製品とサービスに対する需要の変化
 - 急速な技術革新、変化する顧客ニーズにタイムリーに対応する製品やサービスを東京エレクトロンが継続的に開発し提供していける能力
- 詳細につきましては、P22の事業等のリスクをご覧ください。

プロフィール

半導体製造装置、FPD（フラットパネルディスプレイ）製造装置のリーディングサプライヤーである東京エレクトロンは、世界の半導体デバイスメーカー・液晶パネルメーカーに、優れたプロセス性能と量産性能を持つ数々の製品を、確かな技術サービスとともに提供しています。また、2008年には太陽電池製造装置を製品ラインアップに加えました。

東京エレクトロンのマーケットリーダーとしての地位を揺るぎないものにしてきているのは、1963年の創業以来受け継がれてきた、徹底した顧客満足の追求です。お客様の真のニーズを迅速に、的確に掴み、先進的な製品の創出につなげることを強みとしています。

日本、アメリカ、ヨーロッパ、アジア、各地域に広がるグローバル拠点をベースに、東京エレクトロンは世界中のお客様の生産ラインに日夜貢献し、たゆまぬ技術革新を通じて、デジタルネットワーク時代の未来を切り拓いていきます。

アイコンの紹介

◀ 前のページへ

▶ 次のページへ

↶ 直前に開いたページへ戻る

目次へ

🔍 PDF内の文字を検索

🖨️ 印刷

▶ ビデオ

⊕ 拡大

ハイライト

■ 連結財務ハイライト

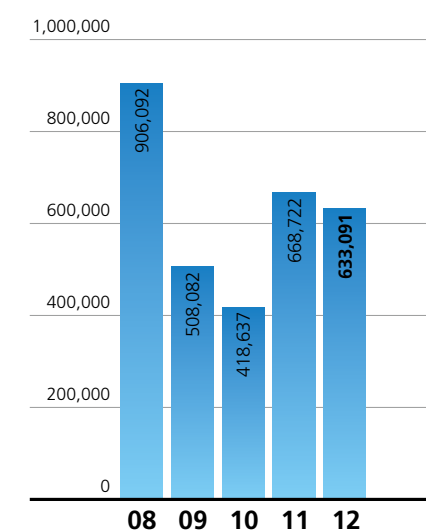
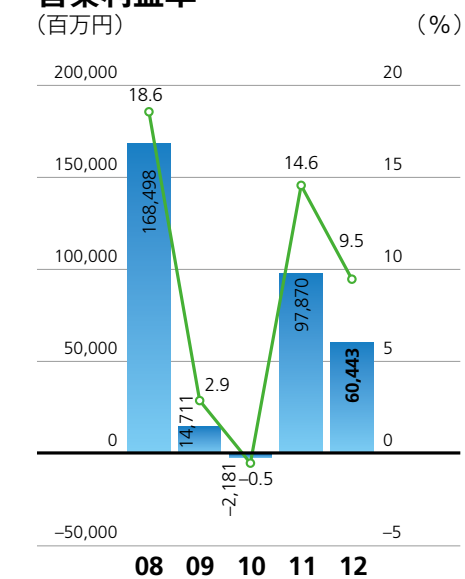
連結財務ハイライト

3月31日に終了した事業年度	百万円					千米ドル	
	2008	2009	2010	2011	2012	2012	
会計年度:							
売上高	¥906,092	¥508,082	¥418,637	¥668,722	¥633,091	\$7,702,774	
営業利益(損失)	168,498	14,711	(2,181)	97,870	60,443	735,406	
税金等調整前当期純利益(損失) ..	169,220	9,637	(7,768)	99,579	60,602	737,340	
当期純利益(損失)	106,271	7,543	(9,033)	71,924	36,726	446,843	
減価償却費	21,413	23,068	20,002	17,707	24,198	294,415	
設備投資額	22,703	18,108	14,919	39,140	39,541	481,093	
研究開発費	66,073	60,988	54,074	70,568	81,506	991,678	
営業利益率	18.6%	2.9%	(0.5)%	14.6%	9.5%		
ROE	21.4%	1.4%	(1.8)%	13.3%	6.3%		

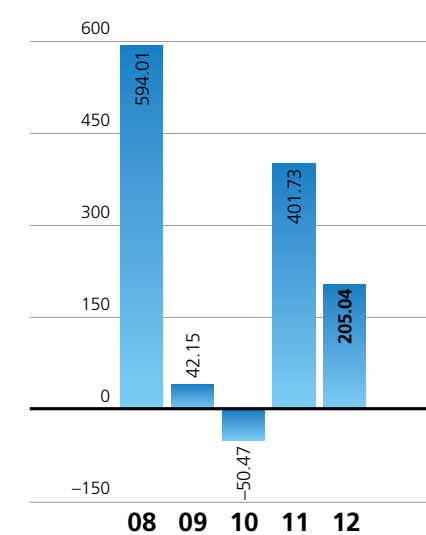
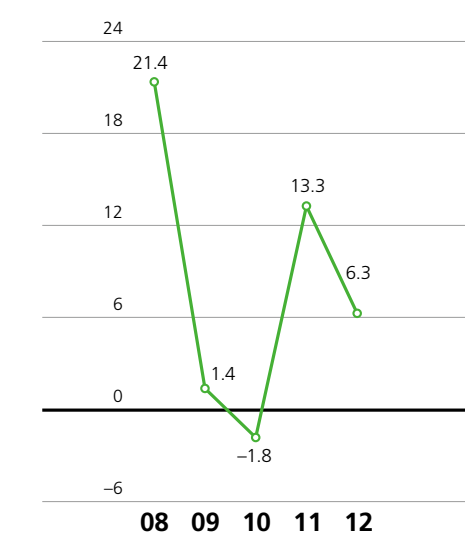
会計年度末:	百万円					千米ドル	
	総資産	¥792,818	¥668,998	¥696,352	¥809,205	¥783,611	\$9,534,140
純資産	545,245	529,265	523,370	584,802	598,603	7,283,161	

1株当たり情報:	円					ドル	
	当期純利益(損失)	¥ 594.01	¥ 42.15	¥ (50.47)	¥ 401.73	¥ 205.04	\$ 2.49
配当金	125.00	24.00	12.00	114.00	80.00	0.97	

注記: 1. 米ドル表示は、2012年3月31日の為替レート1ドル=82.19円で換算しています。
2. 減価償却費には、のれん償却額および減損損失は含まれていません。

売上高
(百万円)営業利益(損失)および
営業利益率

■ 営業利益(損失)
○ 営業利益率

1株当たり当期純利益(損失)
(円)ROE
(%)

トップメッセージ

■ ステークホルダーの皆様へ

ステークホルダーの皆様へ



取締役会長 東 哲郎

代表取締役社長 竹中 博司

2012年3月期は、東日本大震災の影響に加え、タイの大洪水、長引く歴史的な円高、さらには欧州金融リスクなど、日本を取り巻く経済環境は一層厳しく混沌とした1年でした。当社が位置するエレクトロニクス産業においても、日本を代表する企業ですら大変厳しい状況に直面していることが日々新聞等で報道されています。

このような中、当社の業績は、一部税制改正等の影響を受けたものの、売上高6,331億円、営業利益604億円、当期純利益367億円という結果を残すことができました。これもひとえにお客様をはじめとするステークホルダーの皆様からのご支援の賜物と深く感謝申し上げます。

一気にブレイクしたスマートフォンとタブレット。モバイル時代の幕開けを私たちは、今、目の当たりにしています。これらモバイル機器の出荷台数は、先進国でのさらなる浸透に加え、新興経済圏での購買層の広がりにより、今後さらに飛躍的に伸びていくことが期待されています。膨大なデータを受発信するこうした情報端末には、従来にも増して高性能の半導体が必要になりますが、その半導体の進化を可能にするのが、半導体製造装置の技術革新です。半導体製造装置市場は短期的にはシリコンサイクルやマクロ経済の影響を受けるものの、半導体の進化と莫大な量の拡大を支えるために、これからも技術革新を繰り返しながら成長を持続していきます。当社は、このダイナミックな市場の中で、今後もお客様の求める優れた製品・技術の提供を通して、モバイル時代を根底から支える役割を担っていきます。

東京エレクトロンは、中長期ビジョンに基づき、この2年間で5年、10年先の事業成長を睨んだ基盤づくりの年と位置付け、高水準の成長投資を行ってまいりました。研究開発費は、主力事業である既存の半導体製造装置事業の強化に加え、最先端パッケージプロセスとして脚光を浴びる三次元積層技術、次世代薄型ディスプレイとして台頭してきた有機ELディスプレイ用の製造装置、そして環境エネルギー技術としてメガソーラー発電に最適と考える薄膜シリコン太陽電池製造装置など、いずれも当社のコアである半導体製造装置技術が活かせる新たな事業分野の構築に投じてまいりました。近い将来、これらの新分野が当社のさらなる発展に向けた成長のエンジンとなるよう、全力をあげて育てていきます。

東京エレクトロンは、今年創立50年目を迎えます。半導体が産声をあげてから半世紀以上が経ちますが、今なお技術革新という脱皮を繰り返しながら成長を続けるこの稀有な業界で、当社は、今後も製造装置のグローバルリーダーとして、人々の豊かなくらしの実現のみならず、技術で地球環境に貢献する企業になりたいと思っています。そして、その理念を実現するためには、経営者と社員が一体となってその使命感を共有し、より誇りの持てる会社、夢と活力が湧く会社であることが重要と考えています。ステークホルダーの皆様にとりましてもより魅力的な価値の高い企業になれますよう、会社の経営に真摯な姿勢で取り組んでまいりますので、今後も変わらぬご支援をお願い申し上げます。

2012年6月

取締役会長 東 哲郎

代表取締役社長 竹中 博司

社長インタビュー



代表取締役社長
竹中 博司

将来に向けた設備投資関連では、エッチング装置事業強化のための宮城新工場、拡大する中国パネル需要に現地化で対応するための中国昆山工場、国内における基礎研究開発の充実と太陽電池製造装置事業化促進のための東京エレクトロンテクノロジーセンターつくばの3つの製造・開発拠点を新たに設けました。さらにこの4月には、躍進する韓国半導体市場での事業強化のため、韓国ファソン市にTELテクノロジーセンターコリアを設立するなど、それぞれの目的に応じて将来に向けての投資を行いました。

加えて、買収を2件発表しています。常々、当社の成長の源泉は技術革新にあると申し上げておりますが、買収には三つのカテゴリーがあると思います。一つは現事業の強化のため、二つ目は関連する事業の拡大のため、そして最後は新たな事業への参画のためです。いずれも、当社にはない技術を取り込み、当社が持つ技術との融合により付加価値の高い事業を産み出すためのものです。今回の買収は、成長率の高い半導体先端パッケージング分野での製品群の充実と、当社が培った技術が活かせる薄膜シリコン太陽電池製造装置分野に新たに参入することを目的としたものです。

2012年3月期、経営においてどのような進展がありましたか。

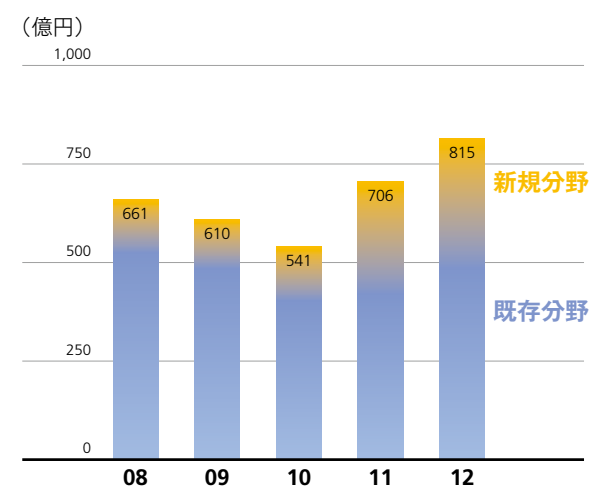
2011年3月に発生した東日本大震災に加え、歴史的な円高傾向加速、さらにはタイの洪水の影響で最終製品が落ち込むなど、当社を取り巻くこの1年のビジネス環境は大変厳しいものでした。そのような中でも、震災からの復旧への全社一丸となった対応によりその影響を最小限に抑えることができましたが、全社売上は前期比約5%の減少となりました。

一方、将来の成長に備えての成長投資を前期に続いて手厚く行いました。研究開発にはこれまでで最高の815億円を投じましたが、注力分野であるエッチング装置、洗浄装置の市場におけるポジションが向上するなど、成果が少しずつ現れ始めています。同時に、いくつかの新規事業分野の開発においても、着実に前進をした年となりました。

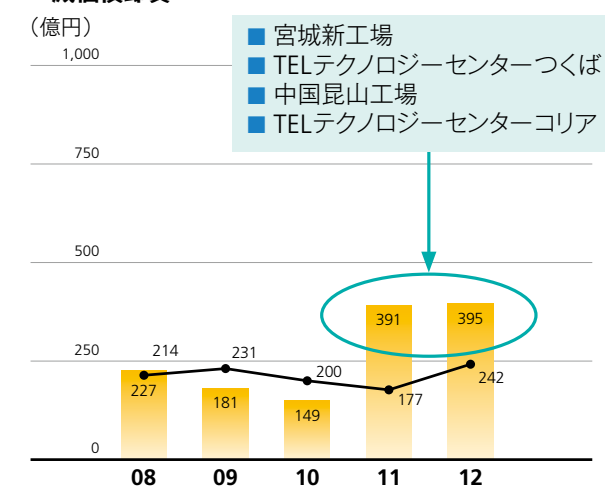
中期成長のための先行投資

この2年間、将来の成長を睨んだ高水準の研究開発投資および設備投資を実行。

■ 研究開発費



■ 設備投資額
◆ 減価償却費



社長インタビュー

3年前の世界金融危機以降、半導体製造装置市場は伸び悩んでいるように見受けられますが、今後の産業の行方をどのように見えていますか。

Aすでに以前より半導体市場では国境のないボーダレスの激しい競争が行われており、昨今の新聞紙上を見ても、特に日本のエレクトロニクス産業についてはグローバル競争において厳しい戦いを余儀なくされている状況が見受けられます。世界全体を見ても、世界金融危機の影響をいまだ引きずり、最終エレクトロニクス製品の需要はまだ弱いのがあります。

しかし、一方でPCやスマートフォンに始まり、それらを使ってインターネットの中で飛び交う膨大なデータの処理を行うサーバー、また、数々のデジタル家電、あるいは自動車や医療機器への広がりに加え、それらの新興国への加速度的拡大を考えると、半導体の需要拡大、技術進化はまだこれからも無限に続いていくものと考えられます。モバイル時代の到来は、まさに半導体の第二成長期の始まりを告げていると言えるでしょう。

そして、その半導体の進化を支えるのは製造装置のたゆまぬ技術革新であり、改めてこのことの重要性を認識しています。

東京エレクトロンを取り巻く事業環境にどのような変化が起きていますか。それに対して、どのように対処して、事業チャンスとしていきますか。

A当社の半導体製造装置の海外売上比率は今や85%近くになり、またごく少数のお客様が多額の投資をする傾向が顕著になってきています。

このような環境の変化を受けて、当社は最も重要な研究開発を世界的な半導体メーカーの近くで展開しています。日本はもとより、米国、韓国、台湾それぞれに最先端プロセス開発センターを置いて、お客様の半導体開発にその早い段階から一緒に携わらせていただき、お客様の求める次の世代の製品を早期に具現化するよう注力しています。

一方、製造は、日本のものづくりの強さを最大限に発揮するために基本的に日本中心で進めていますが、昨今の円高メリットを取り入れるべく部品や材料の調達にはアジアにも対象を広げ、海外調達比率の向上を図っていきます。半導体製造装置事業では、このような開発・製造戦略により、当社ポジションの強化と収益性の向上に取り組んでまいります。

一方、フラットパネル製造装置事業についても、市場は今転換点を迎えています。家電量販店に行くと、大型液晶テレビの大幅な値下がりを目にします。液晶パネルがコモディティ化し、製造装置もアジア勢の台頭で強い価格攻勢を受けていますが、当社は巨大な潜在需要を持つ中国で製造インフラを構築し、市場での優位性を保つとともに、コスト改善に努めていきます。また、液晶テレビの次の世代として有望な有機ELテレビ市場が、2015年頃を目途に本格的に立ち上がることを視野に、大型パネル向けの有機EL製造装置の製品化を加速させ、事業化を目指してまいります。

グローバルな開発体制を充実

世界の主要顧客に密着した開発体制で、お客様の求める製品を早期に創出する。



社長インタビュー

新規事業について、もう少しお話を聞かせてください。

A この2年間の高水準の開発・設備投資、そしてこのたび発表した2件の企業買収は、現事業の強化に加え、東京エレクトロンの新たな成長ドライバーの創出を狙うものです。

新しいプラズマ技術であるRadial Line Slot Antenna技術をベースとした新製品、パッケージング分野における三次元積層技術、次世代テストシステム、有機EL製造装置、薄膜シリコン太陽電池製造装置などです。これらの事業が成長すれば、全体では優に1,000億円から2,000億円規模の新たなビジネスを創出します。

また、半導体メモリの微細化の困難さが増す中、いよいよ次世代メモリの有力候補であるSTT-MRAM時代の足音が聞こえてきました。当社は、この革新的新デバイスの実現に向け、この分野で世界最高峰の技術を有する東北大学と連携し、製造装置メーカーとしてその量産化技術の実現に挑戦していきます。

当社の主幹事業である半導体製造装置事業の既存製品分野に加え、新規事業分野が立ち上がり、さらにはSTT-MRAMデバイスの量産化技術が実現すれば新たな成長路線が確立できるものと期待しています。

新規分野への事業展開

コアである半導体製造装置技術が活かせる新規事業領域に進出し、事業拡大を目指す。



Q キャッシュが安定的に創出される体質に変貌を遂げていますが、株主還元の方針、キャッシュの使い方についてお聞かせください。

A 2011年3月期期末配当より、株主還元強化の一環として、業績連動の配当性向をそれまでの20%から35%に引き上げさせていただきました。また、2013年3月期は、来期50周年を迎えるにあたって、日頃当社を支えてくださっている株主様への御礼の気持ちとして、通期で20円の記念配当も実施させていただく予定です。

しかし、株主の皆様から当社が最も期待されているのは、成長による企業価値の向上と受け止めています。従って、今後も余剰資金は、第一に技術開発投資、企業買収も含めた成長投資に使わせていただきたいと思います。

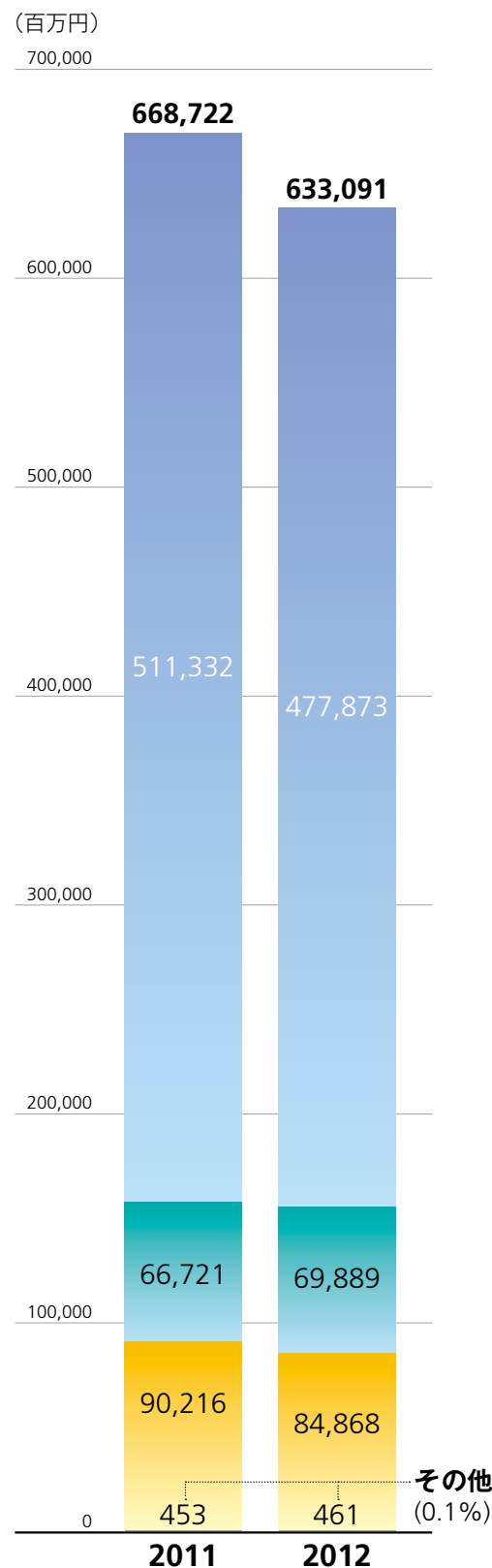
同時に、自社株買いにつきましても状況に応じて適切に判断し、売上・利益成長とROE向上の両輪を意識した経営で、企業価値向上に向けて舵取りを行ってまいります。

セグメント情報

■ 東京エレクトロンの事業概要

東京エレクトロンの事業概要

売上高



事業概要

半導体製造装置

スマートフォンやタブレットなど、デジタル製品の基幹部品である半導体デバイス(ICチップ)。その生産を担う半導体製造装置を幅広く取り揃え、優れた技術サポートとともに提供しています。

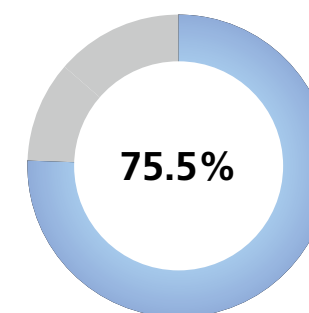
ウェーハプロセス工程で使われるコータ/デベロッパ、プラズマエッチング装置、熱処理成膜装置、枚葉成膜装置、洗浄装置、そして、ウェーハ検査工程で使われるウェーハプローバの6製品群をラインアップ。また、シリコン貫通電極(TSV)形成などの先端パッケージング工程で使われる製品ラインアップの拡充も進めています。

主要取扱い製品

- コータ/デベロッパ
- プラズマエッチング装置
層間絶縁膜エッチング装置・シリコンエッチング装置
- 熱処理成膜装置
- 枚葉成膜装置
CVD装置・プラズマ処理装置

- 洗浄装置
オートウェットステーション・枚葉洗浄装置
ブリククリーン装置・スクラバーシステム
- ウェーハプローバ

売上高構成比



事業概要

FPD/PV製造装置

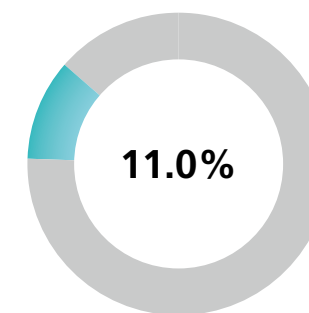
美しく鮮やかな映像を映し出すパソコンや液晶テレビのディスプレイ。その生産を担うFPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置を、確かな技術サポートとともに提供しています。製品ラインアップは、FPDコータ/デベロッパとプラズマエッチング/アッシング装置。

地球環境にやさしいクリーンエネルギーとして注目を浴びる太陽電池。2008年、当社の事業領域に新しくPV(太陽電池)製造装置分野が加わりました。

主要取扱い製品

- FPDコータ/デベロッパ
- FPDプラズマエッチング/アッシング装置
- 薄膜シリコン太陽電池用プラズマCVD装置
- 薄膜シリコン太陽電池用一貫製造ライン(スイス エリコンソーラー社のアジア・オセアニア地域における独占販売代理店として)

売上高構成比



事業概要

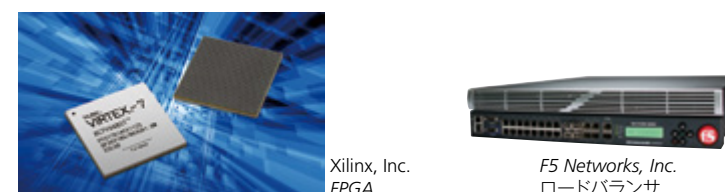
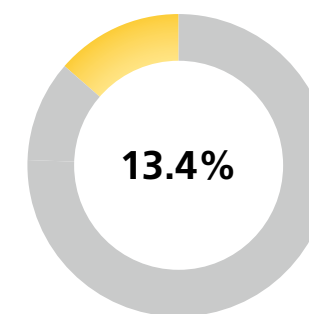
電子部品・情報通信機器

世界の優れた電子部品、コンピュータ・ネットワーク機器などを多彩に取り揃え、販売を行う「商社ビジネス」と、お客様のニーズに応じて設計開発や自社ブランド商品の開発を行う「開発ビジネス」の二つの機能を有する、新しい形態のビジネスを展開しています。東京エレクトロンデバイス株式会社が当事業のオペレーションを行っています。

主要取扱い製品

- 半導体製品
- 電子部品他
- コンピュータ・ネットワーク機器
- ソフトウェア

売上高構成比



セグメント情報

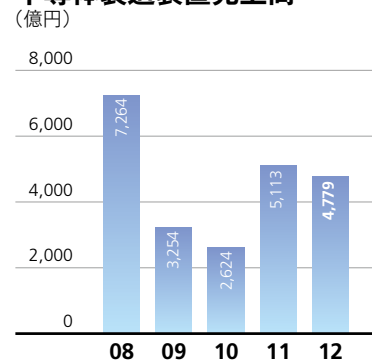
■ 部門別営業概況および事業展望

部門別営業概況および事業展望

2012年3月期概況

半導体製造装置

半導体製造装置売上高



2012年3月期の世界経済は、欧州の財政危機に端を発する先行き不透明感から先進国を中心に景気減速傾向が見られましたが、期後半には米国を中心に緩やかな回復の兆しが見え始めました。本格的な普及期を迎えたスマートフォン、タブレットなどの先端モバイル機器向けの需要を追い風に、省電力化、通信規格の高度化に対応したロジック系半導体の生産は堅調に推移しました。一方、パソコンの成長率の鈍化の影響を受け、DRAMは生産調整を余儀なくされました。

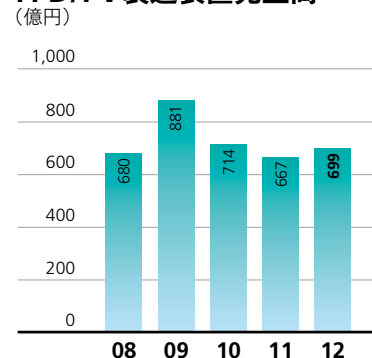
このような市場環境のもと、当部門の売上高は、ロジック向け微細化投資が堅調であった一方、メモリ向け設備投資が手控えられたことにより、前期比6.5%減少の4,779億円となりました。

地域別では、欧州が73%、韓国が24%、米国が12%の増加となりましたが、それ以外の地域では前期を下回る売上となりました。特に台湾がDRAM向け半導体設備投資の低迷により大きく50%の減少となりました。

2012年3月期概況

FPD/PV製造装置

FPD/PV製造装置売上高



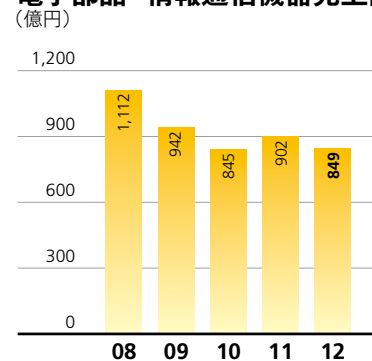
2012年3月期の液晶パネル市場は、スマートフォン、タブレット向けの中・小型パネルの需要が堅調に推移した一方、世界テレビ出荷台数が初めて前年割れをするなど、大型パネルの需要が低調となりました。それに伴い、フラットパネルメーカーの設備投資も、先端モバイル機器向け中・小型パネルが中心となりました。太陽電池市場は、拡大を続けたものの、需給バランス悪化により、太陽電池パネルの価格下落が止まらず、多くの太陽電池関連企業が市場から撤退を余儀なくされる厳しい環境となりました。

当部門の売上高は、フラットパネル製造装置売上が若干の減少となりましたが、太陽電池製造装置売上が増加したことにより、前期比4.7%増加の699億円となりました。

2012年3月期概況

電子部品・情報通信機器

電子部品・情報通信機器売上高



2012年3月期の国内の電子部品市場を見ると、スマートフォンなどのモバイル端末向け市場は順調な拡大を示しましたが、テレビなどを中心とするデジタル家電製品向け需要は低調となりました。IT投資においては、企業や社会活動におけるIT活用の意識向上を背景に、クラウド・コンピューティングの拡大等、徐々に回復に向かう動きが見られました。

当部門の売上高は、前期比5.9%減少の849億円となりました。半導体および電子デバイス事業においては、携帯電話基地局などの通信機器向け半導体の販売は堅調でしたが、民生機器および産業機器向け半導体の販売はともに低迷しました。コンピュータシステム関連事業においては、企業におけるクラウド・コンピューティングへの需要拡大やデータセンターの利用増加により、ストレージ関連を中心に機器販売および保守ビジネスが堅調となりました。

事業展望

スマートフォン、タブレットをはじめとするモバイル機器の普及や、クラウド・コンピューティングの進展に伴うデータ通信量の増大に伴い、今後、莫大な量の半導体が必要になるとともに、半導体のさらなる高集積化、高速化、省電力化のための技術革新が求められてきます。こうした半導体の量的拡大と高度な技術革新を実現していくために、半導体製造装置の果たす役割はますます重要となり、半導体設備投資を牽引していきます。

当社は、こうした市場および技術トレンドを事業拡大につなげるべく、既存製品分野の徹底的強化と新規参入分野の立ち上げに注力していきます。既存分野では、安定した強みを持つコータ/デベロッパおよび熱処理成膜装置においては、今後も高生産性モデルを間断なく投入し、ポジションを盤石なものにしていきます。強化分野であるエッチング装置および洗浄装置においては、顧客評価を通して当社製品の技術優位性の認知度向上を図り、売上成長を目指します。また、枚葉成膜装置ではロジック向けの新たな製品分野への進出、ウェーハプローバではテストコスト削減の要求に応える新製品の投入など、SAM(販売対象市場)の拡大を売上向上に結び付ける戦略も展開していきます。

新規事業分野としては、今後高い成長が見込まれるウェーハレベルパッケージング分野、とりわけ、三次元積層技術分野における事業拡大を目指して、製品の拡充を図っていきます。2012年5月には、この関連技術を持つ米国NEXX Systems社を買収により統合しました。

事業展望

スマートフォン、タブレットなどのモバイル製品に搭載される高精細な中小型ディスプレイ市場が伸長しています。TFT基板には従来のアモルファスシリコンに代って、低温ポリシリコン(LTPS)、あるいは酸化半導体(IGZO)の採用が主流になってきています。また、ポスト液晶として、より高画質で低消費電力の有機ELディスプレイがすでにモバイル向けに実用化されており、いよいよTV向けの大型有機ELディスプレイ製造への取り組みが加速してきました。

当社は、こうした技術革新が進行する中、新しいTFT技術に対応する競争力のある製品の投入、および新規参入となる有機EL成膜装置の市場投入により事業成長を目指します。また、競争激化の中、コスト削減に向けてのオペレーションの効率化も図っていきます。

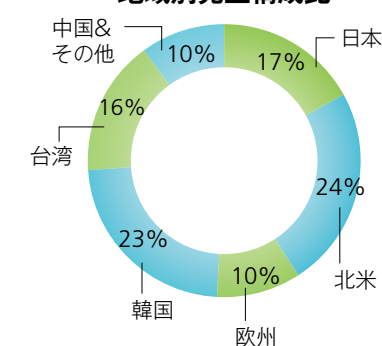
PV事業においては、当社は大規模発電事業向けに最適と考える薄膜シリコン太陽電池製造装置に注力していきます。当技術は、安価な発電コストを特徴としており、高変換効率を実現すれば、中長期的には大きな市場が形成される技術と見ています。茨城県つくば市に今春開設した東京エレクトロンテクノロジーセンターつくばに太陽電池製造技術の研究開発を集約し、早期の事業立ち上げを目指していきます。

事業展望

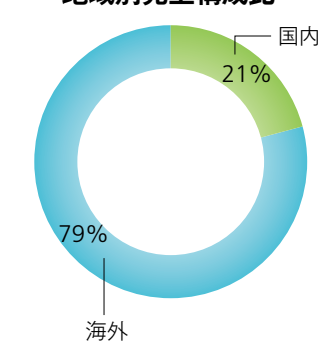
半導体および電子デバイス事業においては、今後もアジア地域の市場成長が持続することが見込まれます。また、コンピュータシステム関連事業においては、クラウド・コンピューティングのさらなる普及を背景としたデータセンターの利用拡大が予想されます。

こうした市場動向を視野に、当事業部門では、これまで行ってきた日系企業向けの海外販売を伸長させることに加え、新たに獲得した商権の海外現地企業への展開、自社ブランド製品inrevium™(インレピアム)の海外拡販など、アジア地域における売上拡大を通して事業成長を目指していきます。また、クラウド・コンピューティング、データセンター向けに、高付加価値の新製品の投入を行うなど、最適なソリューションの提供を通してIT市場の高い成長を取り込んでいきます。

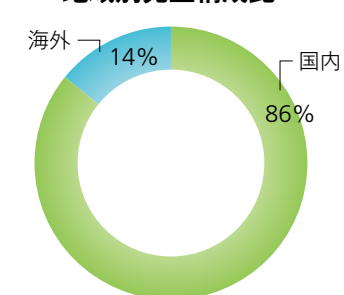
地域別売上構成比



地域別売上構成比



地域別売上構成比



特集

■ 特集 1 |

特集 1

専務執行役員が語る成長戦略— 「製造」「コアSPE」「新たな成長のドライバー」



北山 博文
代表取締役 専務執行役員

「コストの追求においては、直接コストだけに捉われることなく、生産・品質のしゅみを見極めることを忘れてはなりません」



伊東 晃
取締役 専務執行役員

「2012年3月期、半導体製造装置(SPE)事業、とりわけ注力分野において、今後のさらなるポジション向上への足掛かりを築くことができました」



鷲野 憲治
取締役 専務執行役員

「コアである半導体製造装置分野のみならず、これまで培った装置技術が活かせる新分野への投資を継続し、新たな事業創出に挑戦していきます」



お客様への価値の最大化を 基盤とする生産

北山 博文
代表取締役 専務執行役員
製造本部長、品質担当

「世界一の半導体製造装置づくり」への挑戦の一環として、2011年10月、東京エレクトロン宮城新工場の本格稼働を始めました。新工場では、エッチング装置の開発から製造までの一貫体制を活かして、より価値の高い製品をタイムリーに提供し続けることが使命だと考えています。時間・コミュニケーション・コスト面の無駄を徹底的に排除し、製品開発期間を短縮すると同時に、開発段階からの品質向上および生産性向上を実現していきます。また、新工場でチャレンジするフロー生産の最大のねらいは、見える化による生産革新です。

2012年3月には、中国で東電光電半導体設備(昆山)有限公司の本社工場が稼働を開始しました。FPDエッチング装置に使用される部品の補修事業からのスタートで、4月末にはお客様への初出荷を果たしました。最大のねらいは、FPDエッチング装置を市場要求に合致したコストで生産するチャレンジを通して、中長期的にデジタルコンシューマ製品の需要拡大が見込まれる地での生産基盤の構築にあります。

お客様にとっての価値は、「強みとする技術」に裏打ちされた製品であり、「市場要求に適合したコスト」での製品づくりです。宮城と中国の新工場は、まさにこの2つを実践する場となります。

エッチング装置の新生産拠点、稼働開始



東京エレクトロン宮城株式会社

新宮城工場では、開発から製造までの一貫体制、および新生産方式を採用。品質向上と生産性向上を実現していく。

もう一方で意識しなければならないことは、お客様の近くでのスピーディーで質の高いサービス、為替変動、BCP(事業継続計画)、各国固有の政策などです。これらのことと、市場に適合したコストを実現する方策として、現地化・グローバル調達ということも併せて進めています。

台湾・韓国・中国での調達、試作を通して、徐々にではありますがコスト構造の特徴を把握しつつあります。その特徴を十二分に活かすことと、国内および新たな現地パートナー企業との信義を大切にすることが重要と考えています。コストの追求においては、直接コストだけに捉われることなく、生産・品質のしゅみを見極めることを忘れてはなりません。逆説すると、調達はグローバル展開しながらも全ての工程に関わる間接コストを徹底してスリムにすることで、日本でのものづくりの役割と続ける価値が見出せると考えています。

50周年の節目を迎え、お客様へ提供する価値を最大化するという信念に基づき、ものづくりの深化・進化に取り組みたいと思います。

中国昆山新工場、稼働開始



東電光電半導体設備(昆山)有限公司
Tokyo Electron (Kunshan) Limited

薄型ディスプレイ製造の中心地になることが予想される中国にFPD製造装置の生産基盤を構築し、コスト改善とお客様への迅速な対応を目指す。

特集

■ 特集 1 |

特集 1



新製品の積極的投入で、 市場の伸びを上回る成長を目指す

伊東 晃

取締役 専務執行役員
SPE事業担当
SPE営業統括本部長 兼
欧米営業本部長

2008年の世界経済不況後、装置市場には二つの大きな潮流の変化がありました。一つはロジックデバイス向けの投資比率の増大、そしてもう一つは大型設備投資が可能な半導体メーカーに限られてきたこと、いわゆる寡占化の進行です。SPE事業部ではこの変化に対し、ロジックデバイス向け製品の拡充と販売体制の強化を実施してまいりました。

そして、2012年3月期はとりわけ当社注力事業であるエッチング装置と洗浄装置事業分野での市場占有率を高めることに成功、加えて次世代量産装置として大手お客様の認定を受けるなど、将来へのさらなるポジション向上への足掛かりを築くことができました。

一方、製品開発軸でも多くの成果を上げることができました。中でも、ALD*と呼ばれる新しい成膜プロセスが次世代デバイスの製造には欠かせない技術として期待されています。

* ALD: Atomic Layer Deposition

すが、当社はこのプロセス向けにセミバッチタイプのALD装置の開発・製品化に成功、また圧倒的な市場占有率を持つコータ/デベロッパの20nm世代対応モデルもお客様の評価を経て市場への本格投入を開始するまでになりました。

今後もこうした新製品の積極的投入により、高い市場占有率の製品はそのポジションを堅持しつつ、エッチング装置、洗浄装置、またフィールドソリューション事業の一層の競争力強化を図りSPE事業のさらなる拡大を目指してまいります。

そのためにはRadial Line Slot Antennaを用いたプラズマ技術に代表される他社にない技術の開発と、その技術をお客様のニーズに合わせたソリューションとして提供できる人材育成にもグローバルに取り組んでいきたいと考えています。

差別化技術搭載の新製品により売上を拡大する



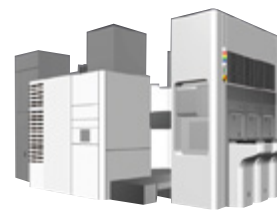
プラズマエッチング装置
Tactras™ RL5A™ Etch

高密度、低ダメージを特徴とするシリコンエッチング装置。クリティカルなトランジスタ形成工程で強みを発揮する。



枚葉洗浄装置
CELLESTA™ -i

業界最高の最大毎時1,000枚のスルーputを実現。高生産性、高性能、省フットプリントで微細化に伴う様々な洗浄課題に対応する。



ALD成膜装置
NT333™

従来のALD手法とは異なるコンセプトを用いたセミバッチシステム。高品質成膜、高生産性の両立を実現する。



時機を捉えて、 成長戦略を具現化する

鷲野 憲治

取締役 専務執行役員
コーポレート事業戦略担当
有機EL/FPD/PVE担当

近年、インターネット上のデータ転送量は、コンピュータのみならず、GPSやセンサーデータなど各種の情報がサーバーに接続されたことにより急増しており、2015年には現在の2倍強になると予想されています。また、スマートフォンやタブレットなどモバイル製品が電子機器市場を牽引しており、高速処理、低消費電力、薄型化のニーズはますます高まるばかりです。

これら、時代の要求を受け、当社は既存の半導体ウェーハプロセス向け製品分野のさらなる強化に加え、今後の高成長が見込まれるウェーハレベルパッケージング事業も拡充してまいります。シリコン貫通電極(TSV)形成のためのエッチング装置やCVD装置のほか、ウェーハボンディング・デボンディング装置も新たにラインアップに加え、お客様から高い評価をいただいています。また、2012年5月ウェーハレベルパッケージング市場でめっきおよび成膜技術に定評のある米国NEXX systems社を買収しました。既存装置とのシナジーの最大化により、事業を積極的に展開してまいります。

ディスプレイ分野では、高精細で消費電力が抑えられる有機ELが大きな注目を集めており、当社はセイコーエプソン(株)と

の協業によりインクジェット方式の塗布装置と、独自技術による蒸着装置の二機種の製品開発を行っています。この変革期を絶好の機会と捉え、新たな技術ニーズに合わせた最適なアプローチでお客様の要求にお応えしてまいります。

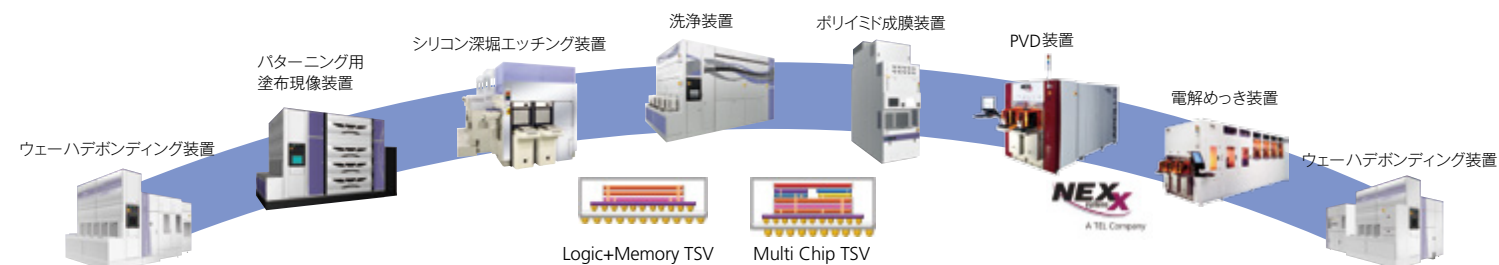
また技術で環境問題に取り組むという信念のもと、太陽電池製造装置事業も強化しており、大規模発電用途などを中心に将来性が期待される薄膜太陽電池の市場拡大の一翼を担うべく装置開発を加速しています。

技術革新が早く、かつ高度な技術が要求される市場での製品開発においては、ニーズの正確な把握に基づく企画力、開発から製品化までを最短時間で実現するスピード、そして装置技術力やサービス力の3点が重要と考えられます。そのためには、自前の技術に拘らず、協業や異業種との連携も視野に入れ、柔軟、かつ積極的に対応していく所存です。

当社は、2012年3月期に過去最大となる815億円の研究開発投資を行いました。今後もコアである半導体製造装置分野のみならず、強みを活かした差別化技術を確認すべく、新分野、新事業への投資を継続し、新たな事業創出に引き続き挑戦してまいります。

伸びる先端パッケージング技術分野の製品ラインアップ

米国NEXX Systems社の買収により、先端パッケージング技術の製品ラインアップを拡充。



特集

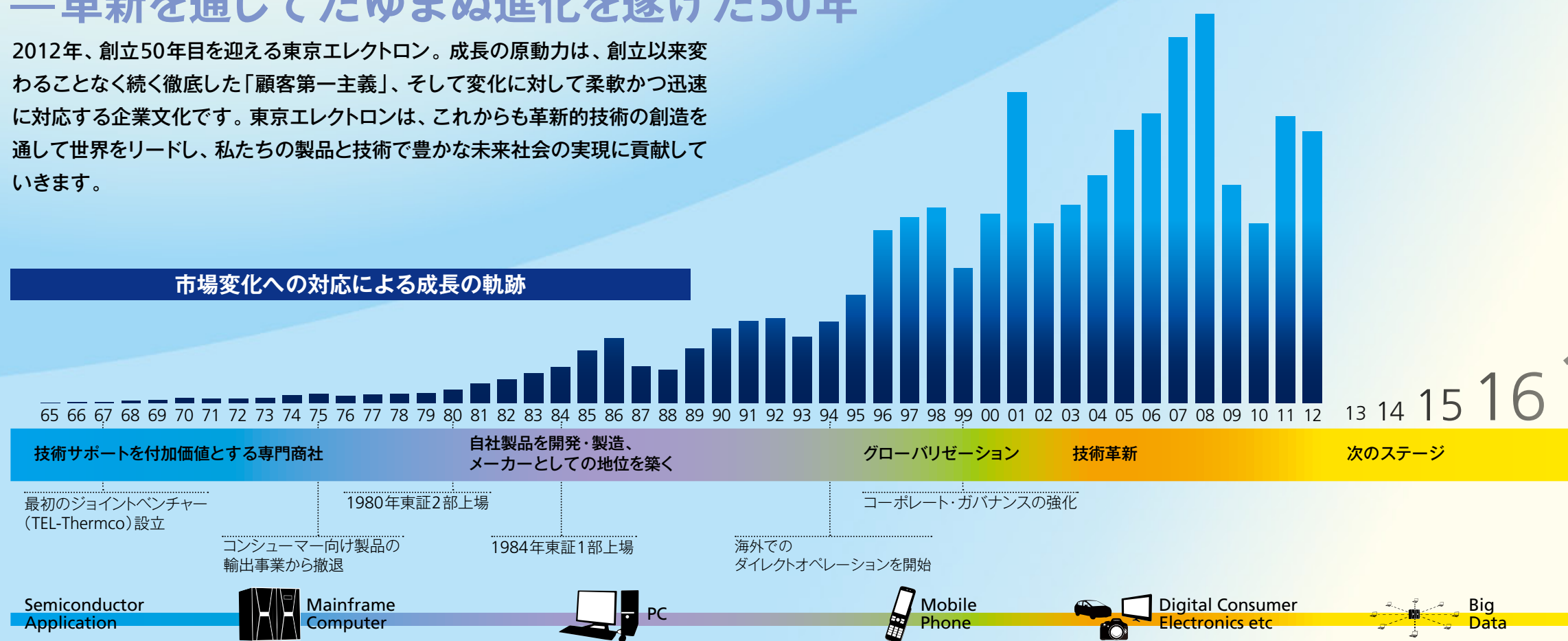
■ 特集 2

特集2

東京エレクトロン —革新を通してたゆまぬ進化を遂げた50年

2012年、創立50年目を迎える東京エレクトロン。成長の原動力は、創立以来変わることなく続く徹底した「顧客第一主義」、そして変化に対して柔軟かつ迅速に対応する企業文化です。東京エレクトロンは、これからも革新的技術の創造を通して世界をリードし、私たちの製品と技術で豊かな未来社会の実現に貢献していきます。

市場変化への対応による成長の軌跡



創立50周年記念ロゴマークのご紹介

東京エレクトロンは、2012年11月11日に創立50年目を迎えるにあたり、創立50周年記念ロゴマークを制定しました。



「夢のある未来社会へ向けて」

このロゴマークは、東京エレクトロン創立50周年を機に、新たな未来へ向けた私たちの意思を表明するシンボルとして制定されました。私たちが標榜する「夢のある未来社会」のあり方を、「ひと」と「先端科学技術」と「環境・自然」が手を取り合い、ひとつの軸として動き出す姿によって象徴しています。

このロゴマークをさまざまなTELのコミュニケーションの場、アプリケーションに活用していたことを通じて、社員同士も手を取り合い、一丸となって未来社会に貢献していけることを願っています。



常石 哲男
取締役副会長

2012年は、当社の創立50年目という大きな節目の年となりますが、株主様、お客様、お取引先の皆様、パートナーの皆様には、今日の成長に至るまでに多大なるご支援、ご指導をいただいたことに深く感謝し、心より御礼申し上げます。

当社は、設立以来、実に驚くほど業態の変化を繰り返し、進化してきました。その時々々の市場のニーズとお客様のご要望に対し、柔軟、迅速かつ大胆に対応することができるDNAを持つことが、現在までの成長の原動力となっています。1963年、当社は技術専門商社として設立され、70年代、80年代と日本の半導体・エレクトロニクス産業の発展と歩調を合わせ大きく成長してきました。商社とメーカーの二つの顔を持つユニークな会社の時期を経て、この約20年間

は、飛躍的な成長を遂げたエレクトロニクス産業界とともに、世界を舞台にトップクラスの製造装置メーカーとして力強く歩んでまいりました。

それが実現できたのも、設立当時から根底にある「顧客第一主義」を徹底し、お客様へ当社が提供する製品と技術の付加価値を最大にし、その価値に見合う利益を頂戴できたことが大きな理由です。その利益をまた最先端技術と高付加価値製品の開発に再投資し、市場・産業界の成長のため、また人々のより豊かな生活の実現に貢献するというポジティブなサイクルを持続させることが、これからのさらなる成長を約束する鍵となると認識しています。また、正直でフランク、公平、そして何事にもオープンマインドで誠意に満ちた風通

しの良い企業文化を通じて、世界中のお客様からの大きな信頼をいただけることとなり、この50年の成長に大いに貢献していると自負しています。

さらなる企業価値の向上に対しては、より高いワールドクラスの目標とパフォーマンスを目指し、参画業界でのテクノロジーリーダーシップを堅持し、さらに大きな夢と活力のあふれるグローバル企業であり続けることが大切であると考えます。今後もこの半導体技術を核としたエレクトロニクス・IT産業界は、さらなる技術革新とともにまだまだ大きな発展を遂げることになるものと確信しています。

コーポレート・ガバナンス

■ コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンス

透明性の確保が成長のダイナミズムを生む



東 哲郎
取締役会長

2012年3月期を振り返りますと、東日本大震災、福島原子力発電所事故に端を発した電力供給不足、タイの洪水によるサプライチェーンの混乱、また、ギリシャ財政危機の影響を受けての円高の進行など、日本の経営環境は大変厳しいものとなりました。しかし、東京エレクトロンは、このアニュアルレポートで触れていますように、東京エレクトロン宮城新工場ほか、当社の将来を担う新しい製造・開発拠点の構築、また、新製品の市場開拓など、重要な布石を積極的に

打つことができました。これも株主様はじめ、ステークホルダーの皆様の暖かいご支援とご理解があったからこそと深く感謝申し上げます。

さて、世界の経済情勢はいまだ不確実な要素が数多くあり、先行きに不透明感を残す状態ですが、このような状況の時にこそ中長期的観点で企業価値向上に向けた施策をはっきりと打ち、未来の姿を示すこと、そして経営の透明性と健全性を維持、強化することが極めて重要であると考えています。そのために

は、株主様から経営の委託を受けている取締役会、経営の執行責任を持つ執行体制、そして執行現場の主体である社員、それぞれが会社の明るい未来を築くべく、夢と活力に満ちたダイナミックな組織として機能しなければなりません。また、この三者間の意思疎通が極めて迅速かつ透明性の高い形で行われ、この三位一体の経営から生まれる経営方針、事業方針が、広くお客様、社会から受け入れられ、期待を生むものでなければなりません。

会社のダイナミックな成長は、以上のようなガバナンスが強化されてこそ確保されるものであり、当社は真のグローバルカンパニーとして、株主様はじめ世界中のステークホルダーの皆様の信頼とご期待に応えるべく、透明性の高い経営を維持、強化していきます。今後もこの観点から会社の執行体制および社員を支え、励まし、アドバイスしてまいります。皆様、今後ともよろしくお願い申し上げます。

コーポレート・ガバナンス

東京エレクトロンは、経営のグローバル化が進行する中、株主をはじめとする全てのステークホルダーにとっての企業価値の向上を重視した経営を推進するため、コーポレート・ガバナンスの強化が重要と考えています。当社は以下の3つの基本方針のもと、実効性の高いガバナンス体制の構築に努め、内部統制システムおよびリスク管理システムの整備・強化を推進しています。

当社のコーポレート・ガバナンスの基本方針

1. 経営の透明性と健全性の確保
2. 迅速な意思決定と事業の効率的執行
3. タイムリーかつ適切な情報開示

コーポレート・ガバナンス体制

当社は会社法に基づく監査役会設置会社でありながら、より経営の透明性・客観性を高めるために、独自の報酬委員会、指名委員会を設置しています。また、執行役員制度を導入し、取締役会と執行機関の機能を分離しています。加えて、株主

に対する経営の透明性が重要であるとの視点に立ち、1999年より代表取締役の個別報酬を開示しています。

取締役会

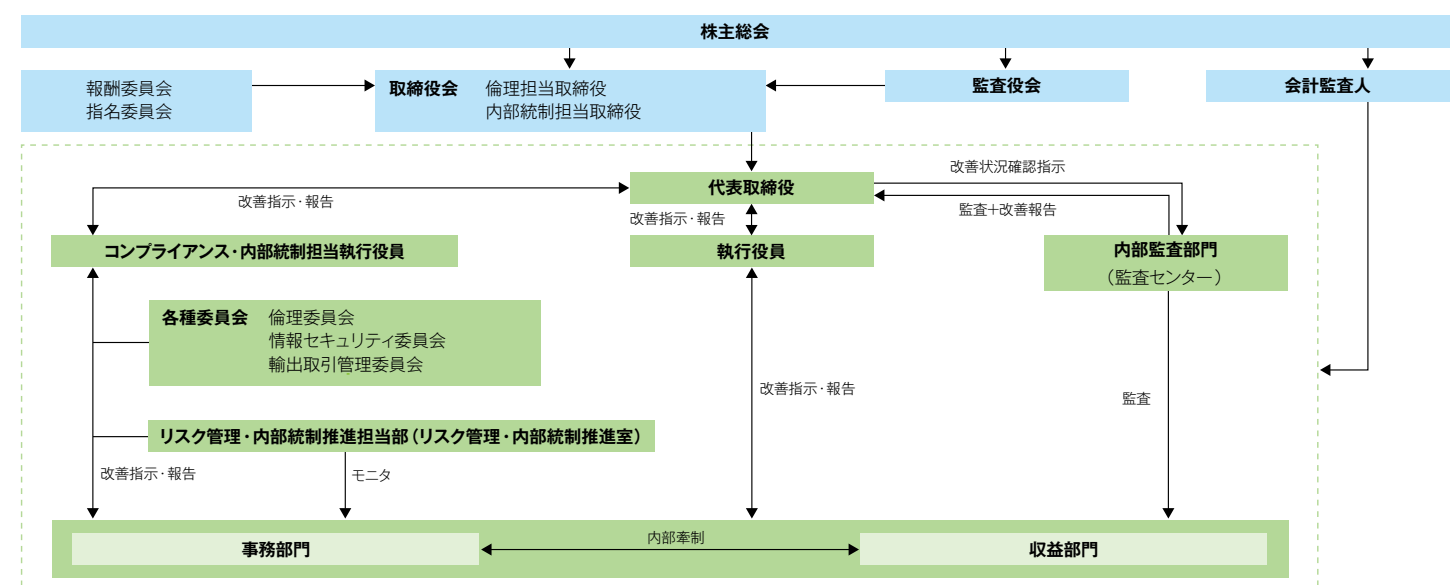
取締役14名（うち社外取締役2名）で取締役会を構成しています。取締役会は原則として月1回開催し、必要な場合は臨時取締役会を開催することとしています（2012年3月期は合計12回の取締役会を開催しました）。経営環境の変化に迅速に対応し、経営責任をより一層明確に示す体制とするため、当社の取締役の任期は1年です。

また、経営の透明性の確保を目的として、独自の報酬委員会と指名委員会を設置し、ガバナンスの向上を目指しています。両委員会とも、委員は代表取締役を除く取締役または監査役で構成しています。

報酬委員会： 役員報酬の制度および代表取締役の個別報酬額を取締役に提案する。

指名委員会： 株主総会で選任される取締役候補および取締役会で選任される最高経営責任者候補を指名し、取締役会に提案する。

コーポレート・ガバナンス、内部統制システムおよびリスク管理体制の模式図



コーポレート・ガバナンス

監査役会

監査役4名(うち社外監査役2名)で監査役会を構成しています。監査役は取締役会、経営会議等の重要な会議に出席するほか、業務監査、会計監査、リスク管理の評価を行うとともに、取締役の職務執行を監査しています。2012年3月期は合計7回の監査役会を開催しました。

社外取締役・社外監査役

当社は、取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保する観点から、井上弘氏((株)東京放送ホールディングス代表取締役会長)、坂根正弘氏((株)小松製作所取締役会長)の2名を社外取締役として、監査の妥当性を客観的に確保する観点から、田近東吾氏、酒井竜児氏(長島・大野・常松法律事務所パートナー弁護士)の2名を社外監査役として招聘しています。なお、田近東吾氏は、常勤監査役として当社グループの監査をしています。

執行役員制度

当社は、取締役会と執行機関の役割をより明確化し、迅速な意思決定とよりスピーディーな事業戦略の立案・実行を図るため、執行役員制を導入しています。

役員報酬

当社は、業績や株主価値との連動性を高めるとともに、企業競争力強化および経営の透明性向上につなげることを目的とした役員報酬制度を採用しています。

1. 取締役の報酬は、月額固定報酬と年次業績連動報酬からなります。
2. 取締役の業績連動報酬制度につきましては、企業価値・株主価値向上に対する要素をより明確に報酬に連動させるため、評価指標として業績連動指標である連結当期純利益と連結自己資本当期純利益率「ROE」の達成度を加味するこ

ととし、当期の重点経営目標指標、特殊な損益および考慮すべき特殊要因等がある場合は必要な調整を行います。業績連動報酬は現金賞与と株式報酬で構成され、その構成割合は概ね1対1としています。株式報酬につきましては、「権利行使価額を1株につき1円に設定した新株予約権」を付与することとし、3年間の権利行使制限期間を設定しています。なお、業績連動報酬額は年間固定報酬額の5倍を上限としています。

3. 年次業績連動報酬において、社外取締役は株式報酬の支給対象外です。
4. 監査役の報酬は、監査役の経営に対する独立性に鑑み、月額固定報酬のみとしています。
5. 役員退職慰労金制度は、役員報酬体系の見直しに伴い、2006年3月期以降を廃止しました。

内部統制システムおよびリスク管理

当社は、企業価値向上のために、また、全てのステークホルダーに対して責任のある行動をとるために、実効性のある内部統制の強化に取り組んでいます。当社取締役会で定めた「東京エレクトロングループにおける内部統制基本方針」に基づく実践的活動を行うとともに、金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制」への対応を実施しています。

内部統制システム

当社グループ全体の内部統制・リスク管理体制をより実効的に強化していくため、内部統制担当取締役およびコンプライアンス・内部統制担当執行役員のもと、リスク管理・内部統制推進室を設置し、当社グループを取り巻くリスクの評価・分析を行い、重要なリスクについては必要な施策を推進してリスク低減に努めています。また、情報セキュリティ委員会、輸出取引管理委員会を設置し、機密情報管理、輸出コンプライアンス体制の一層の強化を図っています。

内部監査部門における監査—監査センター

当社グループ全体の内部監査部門として、監査センターを置いています。監査センターは、当社グループの国内・海外拠点において業務監査、コンプライアンス監査、システム監査を実施し、内部統制システムが有効に機能しているか評価を行い、必要な場合には現場への業務改善の支援を行っています。

監査役と内部監査部門の連携

監査役は、内部監査部門である監査センターの報告会(2012年3月期は合計年13回)等を通じ、内部監査部門と連携をとっています。

監査役と会計監査人との連携

監査役は、会計監査人から当期の監査計画を受領し、監査方法の概要および監査重点項目等について説明を受け、四半期・期末決算時に会計監査人からそれぞれレビューおよび監査結果に関する報告を受けています。

なお、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に対し、迅速かつ正確に監査が実施できるよう、年間を通じて必要な情報、データを提供しています。

コンプライアンス

ステークホルダーからの「信頼」は事業活動の生命線です。この「信頼」を維持するためには、企業倫理とコンプライアンス(法令等遵守)を継続的に実践していくことが欠かせません。「東京エレクトロングループにおける内部統制基本方針」においても、高い倫理観やコンプライアンス意識を持って行動することをグループ全役員・社員に求めています。

倫理基準、倫理担当取締役、倫理委員会

グローバルな事業活動を行うための共通の基準として、1998年に「東京エレクトロングループ倫理基準」を制定しました。また、同1998年より、倫理担当取締役を任命するとともに、企業倫理を浸透させるための運用機関として倫理委員会を設けています。倫理基準とそのQ&Aをまとめた冊子は、日本語・英語・韓国語・中国語で作成され、海外を含むグループ全役員・社員に配布されています。さらに、環境や社会的要求の変化に応じて、倫理基準の見直しを適宜行っており、直近では2011年4月に倫理基準とそのQ&Aを改訂しています。



東京エレクトロンの倫理基準

コンプライアンス・内部統制担当執行役員

当社執行役員の中にコンプライアンス・内部統制担当執行役員を任命し、当社グループにおけるコンプライアンス意識の向上とさらなる徹底に努めています。

コンプライアンスの実践・徹底に向けた取り組み

倫理基準のもと、コンプライアンスに関する基本事項を定めた「コンプライアンス規程」を制定しています。この規程は、当社グループの事業活動に従事する者が、法令・規則、国際的なルールおよび社内のルールを正確に理解し、それらに則した行動を継続的に実践することを目的としています。また、Webを活用した社員教育、社内イントラネットを通じた情報発信等、コンプライアンスの実践と意識向上の施策を実行しています。

コーポレート・ガバナンス

内部通報制度

当社グループでは、法令や企業倫理に反する疑いのある行為について、従業員が直接情報提供を行う手段として、内部通報制度を運営しています。グループ全体の通報窓口として倫理ホットラインとコンプライアンスホットラインを設置するとともに、海外拠点においては拠点毎の通報窓口も設置しています。いずれの窓口においても、通報者の匿名性を保証するとともに、不利益がないことを確保しています。

情報開示

当社は、株主・投資家をはじめとするあらゆるステークホルダーの皆様に当社を正しく、またより深く知っていただき、当社の企業価値を正当に評価していただくために、当社グループに関する情報の公平・公正かつタイムリーな公開に努めています。また、情報公開を通してステークホルダーの皆様からいただくご意見等につきましては、会社経営の参考として社内で活用しています。

情報開示の基準

- 当社は、金融商品取引法および東京証券取引所の定める有価証券上場規程を遵守します。

- 有価証券上場規程に該当しない情報についても、当社を理解していただくために有効と判断した情報については積極的に公平・公正かつタイムリーに開示しています。

情報開示の方法

- 有価証券上場規程に該当する情報（重要事実）は、東京証券取引所のTDnet（Timely Disclosure network：適時開示情報伝達システム）において開示するとともにプレスリリースを行った後、すみやかにWebサイトに同一資料を掲載します。
- 重要事実以外の情報についても、Web、各種印刷物等の情報伝達手段を適宜活用し、ステークホルダーの皆様に公平・公正かつわかりやすく開示しています。
- 当社はアナリスト・投資家向けに決算説明会を開催しており、これはマスメディアにも公開されています。説明会の模様は音声配信にて年2回（本決算・第2四半期決算）、また各四半期決算の説明会資料については全て当社Webサイトに掲載しています。
- 外国人投資家に対し公平な情報提供を行うため、開示情報は、原則、日本語版・英語版を同時にリリースします。ただし、英文翻訳作業の関係でWebサイトへの掲載が多少遅れることがあります。

株主総会に関する取り組み

当社は、株主総会の活性化および議決権行使の円滑化に向け、株主総会日の3週間以上前に株主総会招集通知を早期発送しており、株主総会を集中日以外に開催しています。また、議決権行使の方法については、インターネットを利用した議決権行使を採用するほか、株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームにも参加しています。

招集通知・報告書・決議通知・議決権行使結果・株主総会のプレゼンテーション資料などもWebサイトに掲載しています。



FTSE4Good

東京エレクトロンは、
FTSE4Good Global Index 銘柄に
選定されています

東京エレクトロンは、「FTSE4Good Global Index」銘柄に選定されています。当社は、ロンドン証券取引所の100%出資会社であるFTSE社が世界中の優良企業を対象にした社会的責任投資指標「FTSE4Good Global Index」の銘柄に、2003年9月以来継続して選定されています。

コーポレート・ガバナンスに関する主な制度の有無

報酬委員会	有	代表取締役を除く取締役または監査役で構成
指名委員会	有	代表取締役を除く取締役または監査役で構成
社外取締役	有	14名中2名
社外監査役	有	4名中2名
執行役員制度	有	
代表取締役の個別報酬開示	有	1999年より開示
業績連動型報酬制度	有	監査役は制度の対象外
ストックオプション制度	有	社外取締役、監査役は制度の対象外
役員退職慰労金制度	無	
買収防衛策	無	

取締役・監査役および執行役員

(2012年7月1日現在)

取締役



東 哲郎²
取締役会長



常石 哲男¹
取締役副会長



竹中 博司
代表取締役社長



北山 博文
代表取締役



佐藤 潔
取締役



鷺野 憲治
取締役



伊東 晃
取締役



中村 隆^{2,3,4}
取締役



松岡 孝明
取締役



飽本 正巳
取締役



原田 芳輝¹
取締役



堤 秀介
取締役



井上 弘^{*}
取締役
株式会社東京放送ホールディングス
代表取締役会長



坂根 正弘^{1*}
取締役
株式会社小松製作所
取締役会長

監査役



吉田 光孝²
常勤監査役



森 章次郎
常勤監査役



田近 東吾^{*}
常勤監査役



酒井 竜児^{*}
監査役
長島・大野・常松
法律事務所
弁護士

注記：
1.報酬委員会
2.指名委員会
3.倫理担当取締役
4.内部統制担当取締役
※社外取締役および社外監査役

執行役員

社長・CEO

竹中 博司

専務執行役員

北山 博文
製造本部長、品質担当

鷺野 憲治
コーポレート事業戦略担当
有機EL/FPD/PVE担当

伊東 晃
SPE事業担当
SPE営業統括本部長 兼
欧米営業本部長

常務執行役員

中村 隆
コーポレート管理本部長
コンプライアンス・内部統制担当

飽本 正巳
システム開発本部長

伊藤 高司
PVE本部長

山口 千明
SPE営業統括副本部長

鄭 基市
SPEプロセス開発本部長

保坂 重敏
コーポレート開発本部長

執行役員

原田 芳輝
コーポレート管理本部副本部長
人事/総務/経理/輸出・物流管理担当

堤 秀介
エッチングシステムBUGM

長久保 達也
人事/人材開発センター/
コーポレートブランド推進担当

堀 哲朗
経営戦略/財務/法務/知的財産担当

小泉 恵資
コーポレート調達本部長 兼
IT本部長

池田(楊) 世崇
クライアントラックBUGM

河合 利樹
サーフェスプレバレーションシステムBUGM

多田 新吾
サーマルプロセスシステムBUGM

大久保 豪
枚葉成膜BUGM
有機EL本部長

阿部 祐一
テストシステムBUGM

春原 清
フィールドソリューションBUGM

三田野 好伸
3DI本部長

松浦 次彦
FPDBUGM
有機EL副本部長

笹原 信一
FPD営業本部長 兼
PVプロジェクト担当

七澤 豊
PVE統合プロジェクト推進担当

注記：BUGMはビジネスユニット・ジェネラルマネージャーの略称です。

環境・社会活動

■ 環境・健康・安全に対する取り組み

環境・健康・安全に対する取り組み

東京エレクトロンは、人々の健康と安全を最優先し、地球環境の保全に配慮することを、事業活動を行う企業としての重要な使命と考えています。

基本ポリシー

東京エレクトロンでは、当社の継続的な成長と社会の持続的な発展のために、環境・健康・安全に対する取り組みを経営上の最重要課題の一つと位置付けています。当社が携わるあらゆる分野で環境負荷を低減することに、また、当社やお客様の施設内における安全性について絶対の信頼を確保することに積極的に取り組んでいます。

環境対応活動をより加速させるため、2008年5月に「Technology for Eco life」を環境活動のスローガンに、東京エレクトロンの環境コミットメントを定めました。この中では、2015年に向けてお客様の工場での総合環境負荷の半減を可能にするための装置開発や、当社の事業活動や物流に伴う環境負荷の半減を設定し活動した結果、2012年3月期において前倒しで達成の見込みとなりました。当期より新たな目標を設定し、「Technology for Eco life」のもと、製品技術での貢献を中核に、引き続き地球環境保全活動を継続していきます。

環境・健康・安全への取り組みを進めるためには、ステークホルダーの皆様とのコミュニケーションを推進し、フィードバックを得る相互作用が大切と考えており、社会貢献活動等も積極的に行っています。

EHSマネジメント

東京エレクトロンでは、1997年より、主に製造系の各事業所を中心にISO14001に基づく環境管理システムを構築し、認証を取得しています。また、EHSマネジメントシステムの実効性を高めるために、継続的にシステムや成果のチェック機能を担う監査のレベルアップを図っています。監査は事業所内やグループ内、あるいは第三者による監査など様々な観点から行われています。

製品における環境負荷低減への取り組み

先取りした環境配慮設計に向けて

環境配慮設計の促進は極めて重要なものであると考えています。特に装置の省エネルギー化の促進や、規制含有化学物質の削減・代替化を優先的に取り組むべき課題と位置付けています。

1. 装置使用時における環境負荷低減への取り組み

各事業部の代表的な装置毎に環境負荷低減のロードマップを策定し、各装置のエネルギー消費や熱・排気・水などの用力、使用

化学物質の削減などの施策に関して、技術・運用面からの提案をお客様へ行い、協議しながら多角的に各装置特性にあったアプローチを展開し、目標達成に向け積極的に取り組んでいます。さらに、当社の装置だけでなく、お客様保有の周辺機器の対策や用力の最適化運用なども含めてトータルな環境負荷低減を進めていきます。

2. 装置に含有される規制化学物質への取り組み

東京エレクトロンでは、環境対策の一環として、製品に含まれる有害化学物質の削減を推進しており、製品に使用されるユニットやパーツに含まれる化学物質を専用のデータベースを用いて管理しています。製品を構成する部品の98.5%以上が欧州RoHS指令*で規定された基準を満たしている製品を「含有化学物質削減装置」と位置付け、2008年10月1日から順次出荷を開始しています。

* 欧州RoHS指令：欧州の「電気電子機器中の特定の危険物質の使用制限に関する指令(2002/95/EC)」およびその修正指令を指す。当指令では、規制適用除外用途を除き、最大許容量を超える、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDEが製品に含有することを禁止している。

健康・安全への取り組み

東京エレクトロンでは、社員のみならずお客様、協力会社様などの安全と健康を優先し、また装置の安全性に配慮した設計など、企業活動のあらゆる側面で“安全と健康”を推進しています。

2012年3月期は、重度の人身傷害になりうる事故の撲滅を重点目標に掲げて活動を展開した結果、前期の半減を達成することができました。装置搬入前のクリーンルームの事前確認、現場でのKY(危険予知)活動、安全巡視活動、また事故事例を使った教育などの未然防止策を粘り強く継続してきました。2012年に創立50年目を迎える東京エレクトロンでは、安全のスローガンである“Safety First”の原点に立ち返り、あらためて安全文化の醸成とともに、人身事故・災害の撲滅に全社一丸となり取り組んでいきます。より詳しい活動内容については、「東京エレクトロン環境・社会報告書2012」(2012年9月発行予定)をご覧ください。



東京エレクトロンの環境目標

東京エレクトロングループでは、主要製品の開発から製造・物流・製品使用時といったライフサイクルにおける環境負荷を把握し、2015年までにCO₂排出量を2007年比原単位で半減することを目標に環境負荷低減を進めてきました。

環境目標の達成と新しい環境目標

1. お客様の工場の総合環境負荷を半減することを可能にする装置開発

お客様に納入する装置では300mmウェーハを原単位として、代表装置として選定した装置のほとんどがCO₂排出量50%削減を達成できる見込みとなりました。

2. 事業活動や物流に伴う環境負荷の半減

2-1 お客様向けの物流

2012年3月期のCO₂排出量実績において54%削減、またトンキロの原単位において22%削減となりました。

2-2 事業活動

開発・製造する工場を中心とした事業所の2012年3月期のCO₂排出量は、2008年計画策定時の基準(約:113,000t:対象事業所、電力係数)に対して、宮城事業所、山梨事業所での太陽光発電を含む省エネ環境投資、省エネ活動、また事業所統廃合等により約25,000tの削減を実行し、約88,000tとなりました。また東日

本大震災復興プロジェクトを含む国内クレジット*1などによるカーボンオフセット約50,000t*2、および米国でのグリーン電力も利用することにより、売上高原単位で52%削減、CO₂排出総量において60%以上削減と目標である半減を達成する見込みです。

上記3分野での当初の環境目標が達成の見込みとなったことからこの環境目標はクローズとし、新たな環境目標を今回設定することとしました。

新しい環境目標は、新たに掲げた環境ビジョンに基づき、「製品貢献」「事業所」「調達・物流」の分野で個別目標を掲げるとともに、「環境マネジメント」を強化して、より着実な取り組みをすることで地球環境保全に貢献していきます。新しい環境目標の詳細は、「東京エレクトロン環境・社会報告書2012」(2012年9月発行予定)をご覧ください。

*1 国内クレジット：国内クレジット制度(中小企業等が大企業等から資金や技術・ノウハウ等の提供を受け、協働でCO₂排出削減に取り組む、その削減分を取引できる日本政府のしくみ)で認証されるCO₂排出削減量。

*2 カーボンオフセット：削減が困難な部分の温室効果ガス排出量について、他の場所で実現した温室効果ガスの排出削減・吸収量等(クレジット)を購入することなどにより、その排出量の全部または一部を埋め合わせることで。

サーマルプロセスシステムでの取り組み TELINDY PLUS™

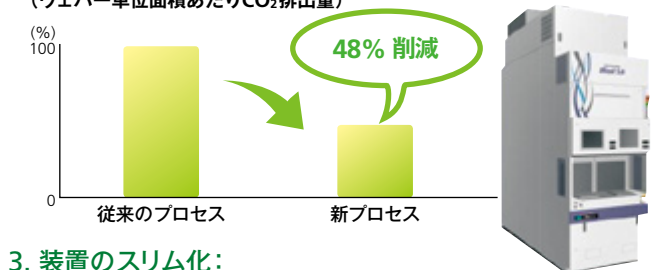
TPS BU*1では、ダブルパターニング*2用シリコン酸化膜の形成のためのプロセスとして、常温でのシリコン酸化膜の成膜プロセスを開発しました。従来のプロセスでは、ガスの分解、気相反応を促進するため数百度のプロセス温度を必要としましたが、新プロセスではガス種の選定、プラズマを利用した酸化種のラジカル化*3などの手法を用いて常温でのプロセス化に成功しました。これらは以下の効果をもたらしています。

1. 工程の削減：

ダブルパターニングによる微細化の実現と高温に弱いレジスト上への成膜が可能となることで、いくつかの工程が削減可能となり、エネルギー、その他ユーティリティの低減に貢献

2. 成膜時の環境負荷低減：

成膜時に加熱が不要なため、エネルギー、熱排気、冷却水などの負荷がCO₂換算で48%低減

成膜時の環境負荷 (ウェーハ単位面積あたりCO₂排出量)

3. 装置のスリム化：

ウェーハを加熱するためのヒーターが不要となることにより、パーツ数30%、ユニット面積39%が削減可能

*1 TPS BU: Thermal Processing System Business Unit

*2 ダブルパターニング: 微細化加工手法の一つ。

*3 ラジカル化: 原子の状態の一つで、通常は2個1組で軌道上を回転しているはずの電子が1個になっている状態。

東京エレクトロングループの環境への取り組み

環境に関する専門担当部署の設置	環境推進室
環境に関する最高責任機関	取締役会および執行役員会
環境監査の状況	内部、外部ともに年1回、その他グループ間における監査も不定期に実施
環境マネジメントシステムの導入形式	ISO14001を8事業所において取得済み
廃棄物のゼロエミッション	全ての国内製造系事務所において達成済み。リサイクル品の社内利用推進
省エネルギーに対する目標設定	製品の省エネルギー化と事業所における省エネルギー化をともに目標を設定して実施中
従業員に対する環境教育	全ての従業員を対象に実施
環境規則違反による罰則	過去に罰則を科されたことはない

研究開発／知的財産

研究開発

今後も成長を続ける半導体産業

まず、電子機器が世界の隅々まで浸透する上、一つ一つの電子機器に搭載される半導体の数が増加します。さらに、半導体はコンピュータや通信に留まることなく今後医療や農業などにも応用され、幅広く社会を支える基幹部品としてこれまで以上に活躍の領域を広げていきます。

成長を支えるのは技術です。技術開発では、スピードがますます重要になっています。優れた技術も時期を逸すれば、ビジネスを獲得できない厳しい時代です。東京エレクトロンはお客様が必要とする時期に必要な製品をタイムリーに提供するために、お客様に隣接する場所に開発拠点を設け、密接な協力関係を構築して技術の実用化を加速しています。

また、「ハイテク」と呼ばれる最先端技術開発では、様々な専門知識を統合して新しい概念を創出することが必要です。そのために、“外部の知”を積極的に活用するオープン・イノベーションがますます重要になっています。東京エレクトロンは2012年4月、将来技術を担うコーポレート開発部門を山梨からつくばに移転し、“東京エレクトロンテクノロジーセンターつくば”を設立しました。つくばに集積する研究機関との積極的な共同研究を通じて、新半導体材料や太陽光発電の研究開発をはじめ、新しいシーズ技術の育成により一層注力しています。

これらの研究開発は5～10年後、東京エレクトロンの将来の成長を担う製品として結実させていきます。

微細化と三次元積層化への取り組み

微細化技術は半導体の価値を支える根元です。

東京エレクトロンは常に最先端リソグラフィ技術を牽引しています。次世代露光技術として有望なEUV (Extremely Ultra Violet 極端紫外線) 露光レジスト塗布・現像技術の開発に加え、マルチプルパターニング技術も継続的に改良が重ねられています。

さらに、露光せずに物質の化学的特性を利用しパターンを自動的に形成するDSA (Directed Self Assembly 自己組織化誘導) 技術にも大学やコンソーシアムと連携して鋭意取り組み、いかなるリソグラフィ技術の到来にも対応できるように万全の体制を整えています。

一方、複数のチップを積層してより高性能の半導体を目指す3DI (Three Dimensional Integration) 技術に対しては、TSV

(Through Silicon Via シリコン貫通電極)の実現へ向けてシリコン深掘エッチング装置や当社独自の絶縁膜形成装置などを製品化し、3DI時代の本格的到来への準備を怠りなく進めています。

半導体の低消費電力化への取り組み

近年、半導体の消費電力が深刻な問題になっています。小さなシリコンチップ上に天文学的数の微細素子を集積した結果、消費電力が著しく増大し、多量の熱が発生します。大容量のサーバーなど多数の電子機器を集積するデータセンターでは、驚くことに電子機器の冷却に要する電力が電子機器自体の消費電力を上回る事態を招いています。今後、「消費電力の低減なくして半導体の発展なし」と言っても過言ではありません。このような状況を踏まえて今、消費電力の低減へ向けて大きな技術革新が起きつつあります。

一つは、トランジスタの構造と材料の変化により消費電力を低減する取り組みです。動作電圧を下げつつ高性能を実現するために、米国Intel社は世界で初めて、22nmノードで立体構造のトランジスタ(Tri-gate FET)を導入することを明らかにしました。東京エレクトロンは、このような立体構造のトランジスタ形成に必要な独自の低損傷プラズマ技術を応用した製品を開発提供しています。

立体構造に続くトランジスタの革新技術は、ゲルマニウム(Ge)やインジウムガリウム砒素(InGaAs)などの新材料の採用です。



新研究開発拠点 東京エレクトロンテクノロジーセンターつくば
世界有数の研究学園都市つくばに、新研究開発拠点を設立。太陽電池製造技術、半導体製造技術、新しいシーズ技術などを開発していく。

長い歴史のあるシリコンをGeやInGaAsで置き換えるのですから、これは一大変革です。エピタキシャル成長、表面処理、ゲート絶縁膜形成などあらゆる製造プロセスを革新しなければなりません。東京エレクトロンは、この変化を飛躍のきっかけにすべく、新半導体材料用装置、およびプロセス開発に積極的に取り組んでいます。

二つめは、新原理、新材料を用いた不揮発性メモリの開発です。最近、世界の半導体メーカーが次世代デバイスの有力候補であるSTT-MRAM (Spin Transfer Torque-Magnetoresistive Random Access Memory)に注目し、開発を競っています。磁気の方向で“1”、“0”を記録するSTT-MRAMはデータ保持に電力を必要としないため、現在広く使われているDRAMやSRAMの半分以下の電力で動作します。東京エレクトロンはこの分野で世界に冠たる技術を誇る東北大学と共同で最先端の製造技術を開発しており、来るべきSTT-MRAM時代に向けて万全の準備を整えています。

環境・エネルギー問題への取り組み

東京エレクトロンは地球的課題ともいえる環境・エネルギー問題にもグループを挙げて取り組んでいます。

クリーンエネルギー技術といえば太陽光発電です。現在太陽電池産業は、供給過剰とパネル価格下落により厳しい状況が続いていますが、中長期的には大きな成長が期待されています。東京エレクトロンは、シリコン使用量が少なく製造コスト面で有利と

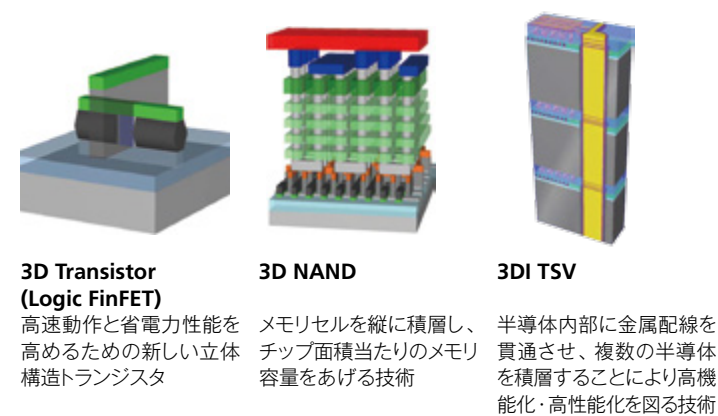
される薄膜シリコン太陽電池が大規模発電用途向けに最適の技術と考え、さらなる変換効率の向上を目指して開発を加速していきます。こうした太陽電池関連の研究開発は新設の東京エレクトロンテクノロジーセンターつくばに集結されます。当センターでは、薄膜シリコンのみならず、化合物、有機系といった異なる材料を使用する太陽電池製造技術の研究も同時に進めていきます。

新分野の探索

持続的成長へ向けて新規分野の開拓にも力を注いでいます。一つの例は、今注目されている印刷技術のエレクトロニクス製造への応用です。パターニングと成膜を兼ねる革新的印刷技術で、ディスプレイパネルの製造コストを大幅に下げられる可能性があります。東京エレクトロンは技術共同研究組合であるJAPER (Japan Advanced Printed Electronics Technology Research Association)に参加して、応用製品の動向を見ながら有望技術の見極めを進めています。

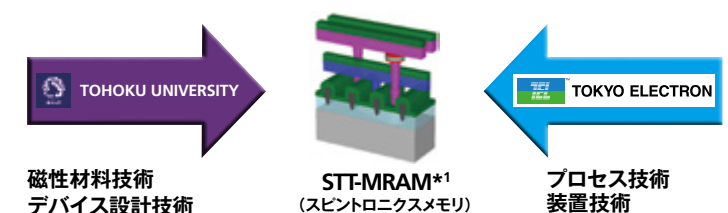
また、ライフサイエンスなど、今後の成長が見込まれる分野にも目を配っています。東京エレクトロンは、微細化をはじめとするさらなる半導体製造技術の進化への挑戦のみならず、当社技術の適用範囲を半導体製造以外に広げる探策を行うなど、新しい産業創造、事業創造に向けた研究開発への取り組みにも着手しています。

進化する半導体



東北大学と次世代メモリを共同開発

- ▶ **STT-MRAM*1の特徴**
- 磁性体材料を採用
 - 低消費電力
 - 不揮発性メモリ



*1 STT-MRAM: Spin Transfer Torque-Magnetoresistive Random Access Memory

研究開発／知的財産

知的財産

知的財産活動の方針

当社では、知的財産活動の基本方針を、事業活動のサポートにより企業収益の向上に貢献することにおいています。知的財産戦略は、技術戦略および製品戦略に沿ったものであるべきであり、知的財産権による自社製品の差別化や競争優位性の確保を他社へのライセンスによる収益よりも優先すべきであると考えています。

技術がますます高度化、複雑化している当社参入分野では、製品開発において他社所有特許を十分に尊重しないと、知的財産にかかる紛争リスクを抱えることとなります。当社では他社の知的財産権を適切にモニターし、必要に応じて他社よりライセンスを取得するなど、適切な対応を行うことで紛争のリスクを最小化しています。

知的財産活動の体制

お客様の要求を満たすため、当社では積極的な研究開発を継続しています。研究開発の成果による競争優位を維持するためには、知的財産権を着実に取得することによってその成果を保護することが不可欠です。そのため、当社知的財産部門では、研究開発部門と密に連携しながら知的財産権の取得を行えるよう、国内の主要工場は出願権利化を担当する知的財産権室を有しています。加えて、海外における研究開発の活発化に伴い、海外拠点においても知財窓口となる現地スタッフを配置しています。また、国をまたいだ技術者の交流や共同開発が増加していることに対応し、2012年3月期、知的財産に関する社内規程を改訂いたしました。

知的財産活動を実効的なものとするためには、激しく変化する市場、技術動向への柔軟な対応も求められます。営業・マーケティング部門と連携して、市場、技術動向をタイムリーに把握できるように、知的財産に関する調査・渉外業務の担当者を営業・マーケティング部門がある本社に配置しています。加えて、出願権利化および調査・渉外業務の担当者と事業部門および開発部門の責任者が知財活動について協議するための会議体を定期的で開催することで、常に知財活動が市場、技術動向に対応したものとできるようにしています。

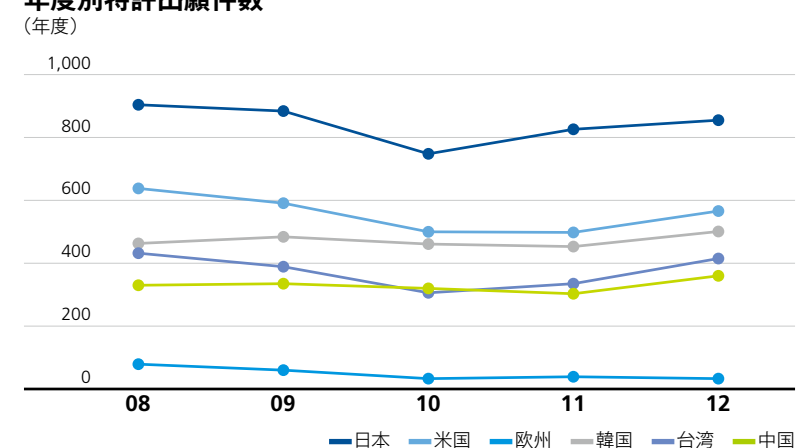
知的財産権の出願、保有状況

当社では、各事業分野の戦略上重要なコア技術の出願に加え、広く周辺技術を包含できるような特許網の構築を積極的に推進しています。

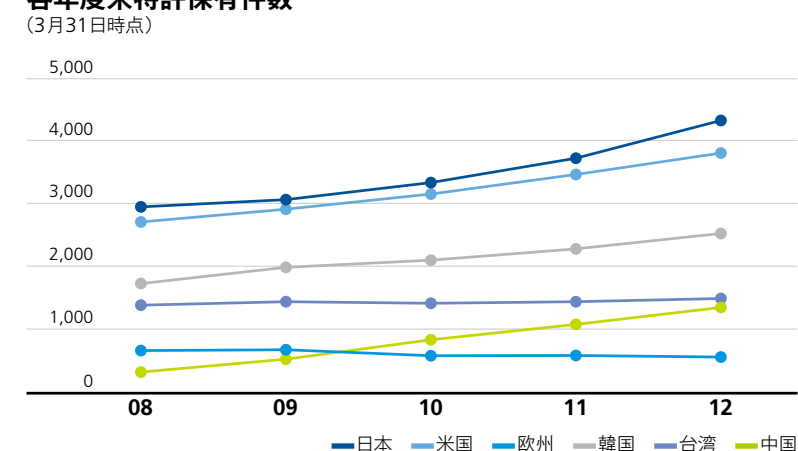
各国における出願件数ならびに保有件数は、各事業分野における市場、競合会社の動向を考慮して常に適正化を図っています。国内外における特許出願ならびに保有状況は、下のグラフのとおりです。当社事業活動における海外市場の重要度に対応し、近年は70%前後のグローバル出願率*1を維持しています。とりわけ、韓国と中国での出願・保有件数を増加させています。これは昨今の事業戦略における韓国や中国の市場としての重要度の高まりと、韓国の半導体およびFPD製造装置メーカー興隆に対応した当社特許戦略によるものです。

*1 日本国特許庁への特許出願のうち外国に出願される件数の比率。日本企業の平均は約25%。

年度別特許出願件数



各年度末特許保有件数



財務概況

損益状況

当期の概況

2012年3月期の世界経済は、欧州の財政危機に端を発する先行き不透明感から先進国を中心に景気減速傾向が見られましたが、期後半には米国を中心に緩やかな回復の兆しが見え始めました。また、中国、インドなどの新興国においては内需を中心とした景気拡大は続きましたが成長スピードには鈍化が見られました。日本経済については、早期に東日本大震災からの立ち直りを見せましたが、その後の世界的な景気停滞や歴史的な円高を受け、回復は緩やかなものとなりました。

当社グループの参画するエレクトロニクス産業においては、スマートフォンやタブレット端末が本格普及期を迎え、好調に推移したものの、パソコン、テレビの販売低迷が続き、これらの基幹部品である半導体、液晶パネルに関しても、積極的な設備投資にまでは至りませんでした。

売上の状況

当期の売上高は、パソコン販売の低迷からメモリ向け半導体設備投資が手控えられ前期比5.3%減少の6,331億円でした。国内売上高は前期比5.9%減少の1,714億円、海外売上高は5.1%減少の4,617億円となり、連結売上高に占める海外売上高の比率は前期の72.8%から72.9%と同水準となりました。

また、パソコンの販売低迷によるDRAMの過剰在庫、また、テレビの販売低迷による液晶パネルの過剰在庫により、当社の顧客である半導体メモリメーカーおよびパネルメーカーの投資意欲が低下し、当期の受注高は前期比26.4%減少の5,410億円、当期末の受注残高は29.8%減少の2,167億円となりました。

売上総利益、販売費及び一般管理費、営業利益(損失)

売上原価は前期比2.8%減少の4,216億円でしたが、売上原価率は前期から1.7ポイント悪化の66.6%となりました。

これにより、売上総利益は9.9%減少の2,114億円となり、売上総利益率は前期の35.1%から33.4%に低下しました。

販売費及び一般管理費は、積極的な研究開発費の投入により、前期比10.3%増加の1,510億円となり、連結売上高に対する比率は前期の20.5%から23.9%に上昇しました。これらの結果、営業利益は前期比38.2%減少の604億円、営業利益率は前期の14.6%から9.5%に低下しました。

研究開発費

研究開発費は、販売費及び一般管理費に含まれます。研究開発費は将来の成長の源泉であるとの考えのもと、前期比15.5%増加の815億円を投じました。

分野別に見ると、半導体製造装置では、各装置分野の次世代モデルの開発に加え、さらなる微細化に対応する独自のダブル・マルチプルパターンニング技術、新しい材料に対応する成膜技術、次世代の有望な露光技術である極端紫外光(EUV)露光技術への対応等の開発に取り組みました。また、こうした既存分野のみならず、3次元積層技術用製造装置、有機EL製造装置、太陽電池製造装置の開発等、新規事業領域への開発投資も積極的に行いました。

その他収益(費用)および当期純利益

当期は、収益として償却債権取立益14億円、開発補助金収入11億円等を、また費用として貸倒引当金繰入額18億円、震災による損失9億円等を計上したことにより、その他収益(費用)は純額で2億円の収益となりました。

この結果、税金等調整前当期純利益606億円(前期は996億円の利益)、当期純利益367億円(前期は719億円の利益)を計上することとなりました。1株当たり当期純利益は205.04円(前期は401.73円の利益)でした。

包括利益

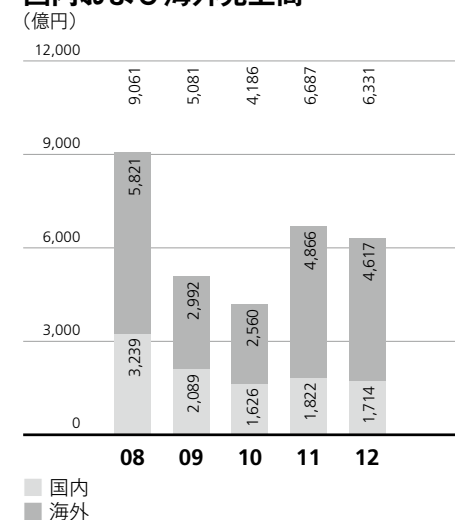
当期は、その他有価証券評価差額金として8億円の利益、円高により為替換算調整勘定として9億円の損失を計上したことにより、包括利益は370億円(前期は696億円)となりました。

配当政策および当期配当金

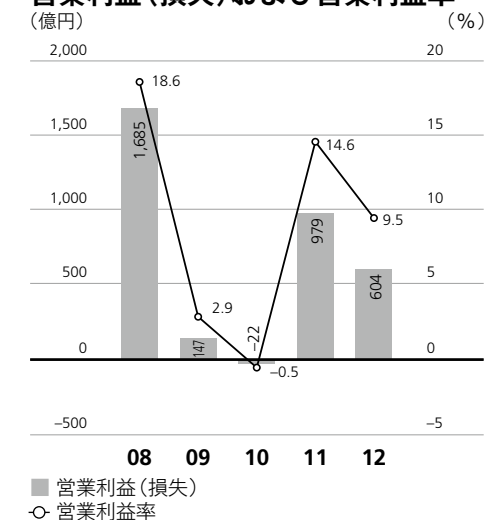
当社は、業績連動型・収益対応型の配当を株主還元の基本方針とし、連結当期純利益に対する配当性向35%を目途とする配当を実施しています。これにより当期の1株当たり配当金については、中間配当は53円(配当性向35.6%)、期末配当は27円(配当性向48.0%)、年間配当は80円(配当性向39.0%)となりました。今後も業容拡大と利益成長を通して株主の皆様のご支援にお応えしていきます。

	百万円				
売上高および利益	2008	2009	2010	2011	2012
売上高	¥906,092	¥508,082	¥418,637	¥668,722	¥633,091
売上総利益	311,298	137,408	108,316	234,758	211,445
売上総利益率	34.4%	27.0%	25.9%	35.1%	33.4%
販売費及び一般管理費	142,800	122,697	110,497	136,888	151,002
営業利益(損失)	168,498	14,711	(2,181)	97,870	60,443
営業利益率	18.6%	2.9%	(0.5)%	14.6%	9.5%
税金等調整前当期純利益(損失)	169,220	9,637	(7,768)	99,579	60,602
当期純利益(損失)	106,271	7,543	(9,033)	71,924	36,726

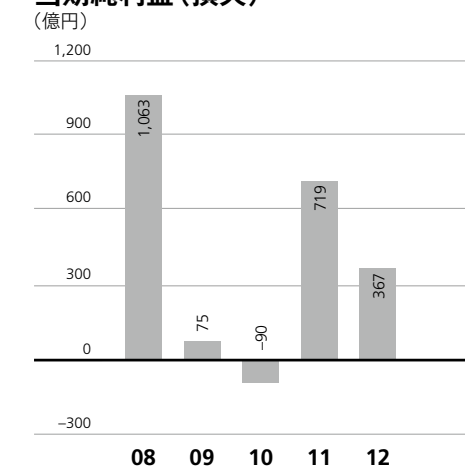
国内および海外売上高



営業利益(損失)および営業利益率



当期純利益(損失)



財務概況

セグメント別の状況

■ 半導体製造装置

スマートフォン、タブレット等の先端モバイル機器にけん引されロジック向け半導体設備投資は堅調であったものの、パソコン販売低迷によりメモリ向け半導体設備投資が手控えられ、当セグメントの売上高(セグメント間の内部売上高又は振替高を含む)は、前期比6.5%減少の4,779億円、セグメント利益は前期比26.3%減少の890億円、セグメント利益率は前期の23.6%から18.6%に低下しました。

なお、当セグメントの外部顧客に対する売上高は前期比6.5%減少の4,779億円となりました。当期の受注高は前期比23.0%減少の4,376億円、期末の受注残高は前期比17.6%減少の1,887億円となりました。

当部門の営業概況については、P8をご参照ください。

■ FPD/PV(フラットパネルディスプレイおよび太陽電池)製造装置

モバイル機器の需要にけん引され中・小型パネル製造装置需要は堅調であったものの、テレビ需要の低迷により大型パネル製造装置需要は低調となりました。太陽電池製造装置売上は前期比で増加しました。当セグメントの売上高(セグメント間の内部売上高又は振替高を含む)は、前期比4.7%増加の699億円、セグメント利益は前期比65.8%減少の23億円、セグメント利益率は前期の10.0%から3.3%に低下しました。

なお、当セグメントの外部顧客に対する売上高は前期比4.7%増加の699億円となりました。当期の受注高は前期比75.3%減少の186億円、期末の受注残高は前期比78.3%減少の142億円となりました。

当部門の営業概況については、P8をご参照ください。

■ 電子部品・情報通信機器

スマートフォンなどのモバイル端末向け商品を除き、民生機器および産業電子機器向け電子部品の需要が鈍化しました。一方、企業におけるクラウドコンピューティングへの需要拡大やデータセンターの利用増加により、情報通信機器の製品販売および保守ビジネスは堅調に推移しました。その結果、当セグメントの売上高(セグメント間の内部売上高又は振替高を含む)は、前期比5.5%減少の863億円、セグメント利益は前期比20.5%減少の23億円、セグメント利益率は前期の3.2%から2.7%に低下しました。

なお、当セグメントの外部顧客に対する売上高は前期比5.9%減少の849億円となりました。当期の受注高は前期比7.4%減少の843億円、期末の受注残高は前期比4.1%減少の138億円となりました。

当部門の営業概況については、P8をご参照ください。

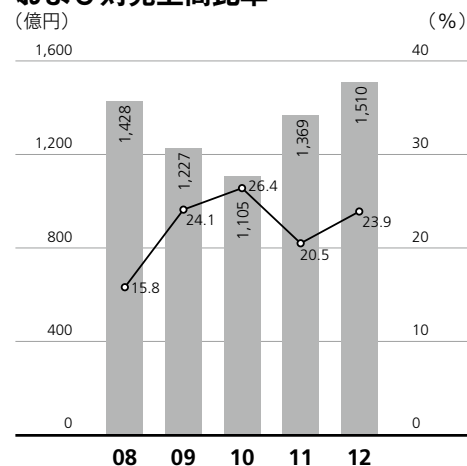
■ その他

その他の売上は、当社グループの製品等の輸送、機器等のリース及び保険業務等の内部サービス関連業務の売上です。

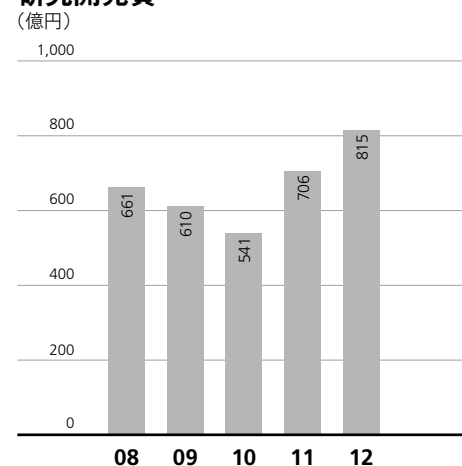
なお、当部門の外部顧客に対する売上高は5億円となり、前期とほぼ同水準でした。

セグメント情報	報告セグメント				合計	調整額	連結財務諸表計上額
	半導体製造装置	FPD/PV製造装置	電子部品・情報通信機器	その他			
2012:							
売上高							
外部顧客への売上高	¥477,873	¥69,889	¥84,868	¥ 461	¥633,091	¥ -	¥633,091
セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	1,432	14,565	15,997	(15,997)	-
計	477,873	69,889	86,300	15,026	649,088	(15,997)	633,091
セグメント利益	89,020	2,271	2,312	1,827	95,430	(34,828)	60,602
セグメント資産	262,789	21,295	46,391	1,927	332,402	451,209	783,611
その他の項目							
減価償却費	11,282	687	570	170	12,709	11,489	24,198
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	13,518	672	407	36	14,633	28,572	43,205

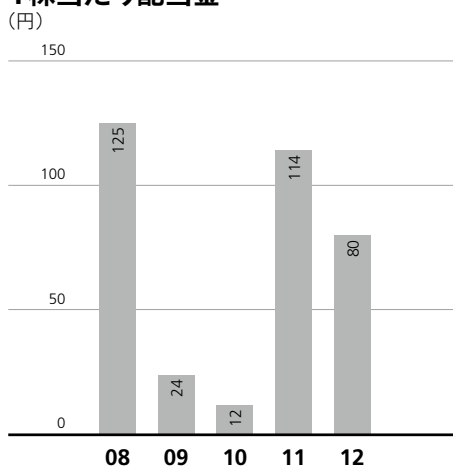
販売費及び一般管理費および対売上高比率



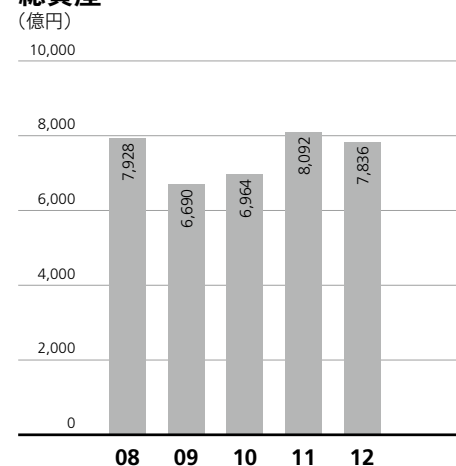
研究開発費



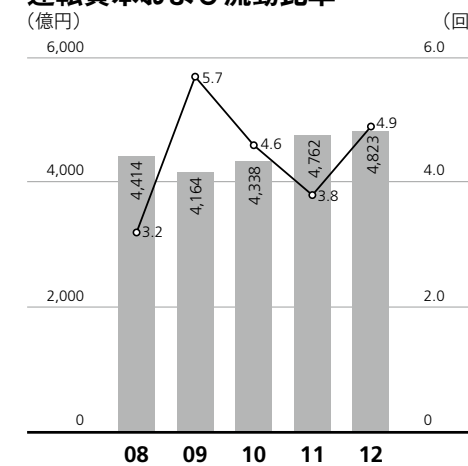
1株当たり配当金



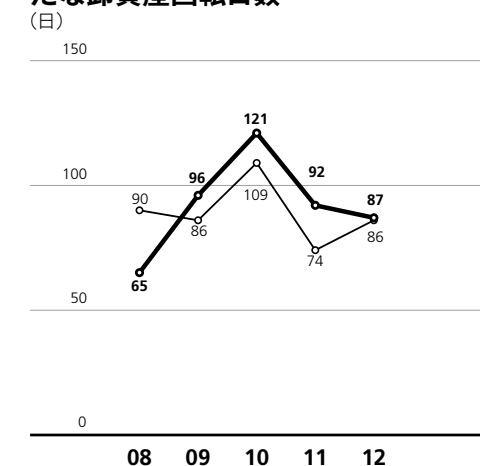
総資産



運転資本および流動比率



売上債権回転日数およびたな卸資産回転日数



■ 販売費及び一般管理費
○ 対売上高比率

■ 運転資本
○ 流動比率

○ 売上債権回転日数
● たな卸資産回転日数

財務概況

財政状態およびキャッシュ・フロー

資産、負債及び純資産

■ 資産

当期の流動資産は、前期末比372億円減少の6,071億円となりました。これは主に手元流動性(現金及び現金同等物に短期投資を加えたもの)が374億円減少、たな卸資産が195億円減少した一方、受取手形及び売掛金が139億円増加したことによるものです。なお、売上債権回転日数は前期の74日から87日に悪化、たな卸資産回転日数は92日から86日に改善しました。

有形固定資産は、新規取得分が395億円ありましたが、減価償却実施額242億円等を差し引き、純額で143億円増加の1,269億円となりました。

投資その他の資産は、前期末比27億円減少の497億円となりました。

これらを合計した総資産は、前期末から256億円減少の7,836億円となりました。

■ 負債及び純資産

流動負債は、前期末比432億円減少の1,248億円となりました。これは主に、未払法人税等の減少210億円、支払手形及び買掛金等の減少55億円、前受金の減少56億円によるものです。なお、有利子負債は短期借入金44億円のみで、デット・エ

クイティ・レシオ(有利子負債/自己資本)は前期末比0.6ポイント低下の0.8%となりました。

長期負債は、前期末比38億円増加の602億円でした。

純資産は、当期純利益367億円の計上および配当金231億円の支払いによる利益剰余金135億円の増加等を主な要因に、前期比138億円増加の5,986億円となりました。この結果、自己資本比率は前期の70.8%から74.9%に改善、自己資本当期純利益率(ROE)は前期の13.3%から6.3%に低下しました。

設備投資額*1および減価償却費*2

当期の設備投資額は、前期比1.0%増加の395億円となりました。主な設備投資は、以下のとおりです。

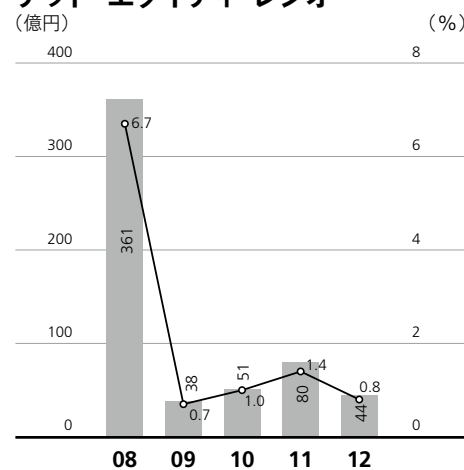
- 東京エレクトロン宮城(株)新工場(宮城県黒川郡大和町)
- Tokyo Electron (Kunshan) Ltd. 工場(中国江蘇省昆山市)
- 東京エレクトロンテクノロジーセンターつくば(茨城県つくば市)
- 評価・測定用機械装置の取得

減価償却費は36.7%増加の242億円でした。

*1 設備投資額は有形固定資産の増加分を示しています。

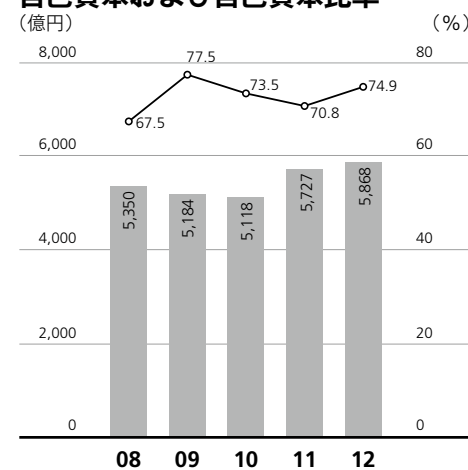
*2 減価償却費にはのれん償却額および減損損失は含まれていません。

財政状態	百万円				
	2008	2009	2010	2011	2012
流動資産	¥640,234	¥505,687	¥552,939	¥644,231	¥607,051
有形固定資産	104,106	99,906	92,128	112,552	126,885
投資その他資産	48,478	63,405	51,285	52,422	49,675
総資産	792,818	668,998	696,352	809,205	783,611
流動負債	198,821	89,272	119,162	168,038	124,794
負債合計	247,573	139,733	172,982	224,403	185,008
純資産	545,245	529,265	523,370	584,802	598,603

有利子負債および
デット・エクイティ・レシオ

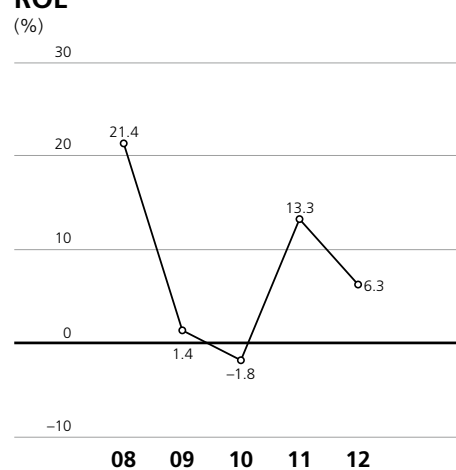
■ 有利子負債
○ デット・エクイティ・レシオ

自己資本および自己資本比率



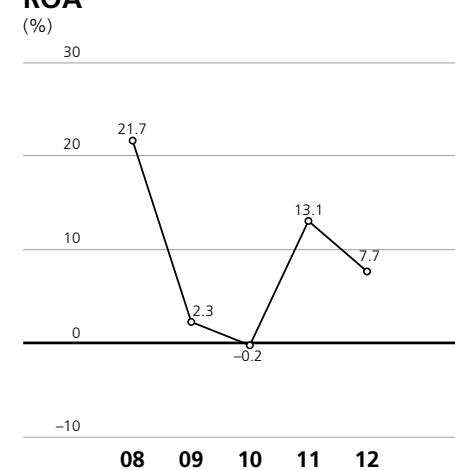
■ 自己資本
○ 自己資本比率

ROE



ROE=当期純利益/期首・期末平均自己資本×100

ROA



ROA=(営業利益+受取利息および受取配当金)/期首・期末平均総資産×100

キャッシュ・フロー	百万円				
	2008	2009	2010	2011	2012
営業活動によるキャッシュ・フロー	¥116,939	¥ 81,030	¥ 48,285	¥ 83,239	¥ 29,712
投資活動によるキャッシュ・フロー	(30,186)	(160,622)	9,613	(35,882)	(8,352)
財務活動によるキャッシュ・フロー	(27,033)	(46,016)	(288)	(5,237)	(27,335)
現金及び現金同等物期末残高	193,493	65,883	123,940	165,051	158,776

キャッシュ・フロー

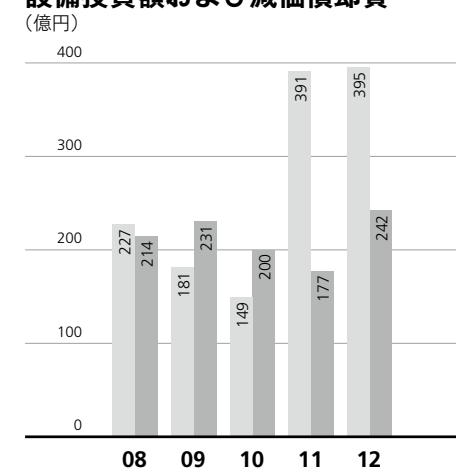
営業活動により獲得したキャッシュ・フローは、前期比535億円減少の297億円となりました。主な内訳は、税金等調整前当期純利益606億円、減価償却費242億円、たな卸資産の減少160億円がそれぞれキャッシュ・フローのプラス要因となった一方、法人税等の支払額476億円、受取手形及び売掛金の増加155億円がそれぞれキャッシュ・フローのマイナス要因となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出360億円、短期投資の純減少による収入310億円により、前期の359億円の支出に対し、84億円の支出となりました。

財務活動により支出したキャッシュ・フローは、主に配当金の支払い231億円、短期借入金の返済36億円により、前期の52億円に対し、273億円となりました。

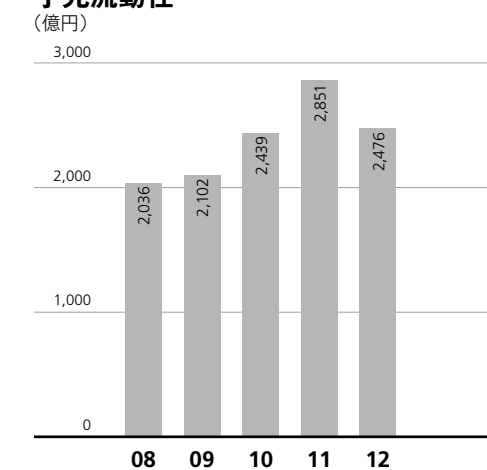
これらの結果、2012年3月末の現金及び現金同等物の残高は、前期末の1,651億円から63億円減少し、1,588億円となりました。なお、現金及び現金同等物に短期投資を加えた残高(手元流動性)は、前期末の2,851億円から374億円減少し、2,476億円となりました。

設備投資額および減価償却費



■ 設備投資額
■ 減価償却費

手元流動性



手元流動性=現金及び現金同等物に短期投資を加えた残高

財務概況

事業等のリスク

当社の経営成績、財務状況及び当社株価等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。

(1) 半導体市場変動による影響

当社は、技術革新が激しく自らの強みを発揮できる半導体製造装置等のハイテク分野に資源を集中させることにより、高い利益率を獲得してきました。半導体市場は技術の変化により大幅に成長する反面、需給バランスが崩れることによって市場規模が一時的に縮小することがあるため、当社はこのような局面においても利益を生み出せるように構造改革にも積極的に取り組んできました。しかしながら、予期せぬ市場規模の大幅な縮小によって、受注取消、過剰設備・人員、在庫増加、顧客の財務状況悪化による貸倒損失、仕入先の経営状態悪化による供給不足等が発生する場合には、当社業績に少なからず悪影響を及ぼす可能性があります。

(2) 特定顧客への取引集中による影響

当社は、優れた最先端技術を搭載した製品及び顧客満足度の高いサービス体制を通じて、国内の大手半導体メーカーを含む世界中の主要な大手半導体メーカーとの取引拡大に成功してきました。大手半導体メーカーの大規模設備投資のタイミングによっては売上高が特定の顧客に一時的に集中することがあり、販売競争の激化によって当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(3) 研究開発による影響

当社は、微細加工技術、真空技術、プラズマ技術、熱処理技術、塗布・現像技術、洗浄技術、ウェーハ搬送技術、クリーン化技術等の最先端技術について積極的な研究開発投資及び研究開発活動を継続的に実施することにより、最先端の技術を創造するとともに、当該技術を搭載した新製品を早期市場投入することによって当グループが参入する各製品分野において上位の市場シェアと高い利益率の獲得に成功してきました。しかしながら、新製品投入タイミングのずれ等の影響により当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(4) 安全に関する影響

当社は、開発・製造・販売・サービス・管理等の各種業務の遂行において安全や健康に対する配慮を常に念頭において行動するという基本理念のもと、当グループ製品の安全性向上や健康影響排除のために積極的かつ継続的に努力しております。しかしながら、当社製品に関連する安全性等の問題により、顧客への損害発生、受注取消等が発生した場合、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(5) 品質に関する影響

当社は、優れた最先端技術を積極的に開発し、新製品に搭載し早期に市場に投入すると同時に、ISO9001の認証取得を含む品質保証体制の確立、及びレベルの高いサービス体制の確立にも努め、その結果、当グループの製品を多くの顧客に採用して頂くことができました。しかしながら、当社の製品が最先端技術製品である等の原因によって、未知の分野の開発技術も多く存在し、予期せぬ不具合品が発生する等により当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(6) 知的財産権に関する影響

当社は、製品の差別化と競争力強化のために、最先端技術早期開発のための研究開発戦略を事業戦略及び知的財産戦略と三位一体で推進することにより、多くの独自技術の専有化を可能とし、各製品分野における高い市場シェアと利益率の確保に成功してきました。しかしながら、当グループの製品は多くの最先端技術が統合・最適化された製品であることもあり、第三者の技術や特許その他の知的財産権を使用する上で制約される場合等があるため、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(7) 外国為替変動による影響

当社は、事業の積極的な海外展開に成功したことにより、海外への売上高比率が高くなっております。当社の輸出は、為替リスクを回避するために円建て取引にて行なうことを原則としておりますが、一部外貨建て輸出も存在し、その場合には受注時の先物為替予約等によって為替リスクヘッジに努めております。しかしながら、急激な為替変動によって価格の変動が生じ為替リスクとなることがあり、当社の業績に間接的に悪影響を及ぼす可能性があります。

(8) その他リスク

当社は、新たな高成長・高収益事業の創出、既存事業におけるさらなる高収益の追求、市場規模縮小時においても利益を生み出すことのできる体質への改善に積極的に取り組むとともに、環境保全活動の推進、コンプライアンスやリスク管理体制及び情報セキュリティ管理体制の再整備にも取り組んできました。しかしながら、当社が事業を遂行する限りにおいては、同業他社及び他業種企業と同様に、世界及び各地域における経済環境、自然災害、戦争、テロ、感染症等の不可抗力、金融・株式市場、政府等による規制、仕入先の供給体制、商品・不動産市況、国内外での人材確保、標準規格化競争、重要人材の喪失等の影響を受け、場合によっては当社業績に悪影響を及ぼすことが想定されます。

財務セクション

■ 11年間の主要財務データ

11年間の主要財務データ

東京エレクトロン株式会社及び連結子会社
2002年3月期から2012年3月期

	千ドル						百万円					
	2012	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002
売上高 ¹	\$7,702,774	¥ 633,091	¥ 668,722	¥ 418,637	¥ 508,082	¥ 906,092	¥ 851,975	¥ 673,686	¥ 635,710	¥ 529,654	¥ 460,580	¥ 417,825
半導体製造装置	5,814,247	477,873	511,332	262,392	325,383	726,440	642,625	486,883	457,191	425,747	364,689	325,715
FPD/PV製造装置 ²	850,335	69,889	66,721	71,361	88,107	68,016	100,766	81,176	75,038	-	-	-
コンピュータ・ネットワーク	-	-	-	-	-	-	19,169	17,497	15,966	18,448	17,193	17,031
電子部品・情報通信機器	1,032,583	84,868	90,216	84,473	94,207	111,181	88,294	86,881	86,249	84,229	77,380	73,658
その他	5,609	461	453	411	385	455	1,121	1,249	1,266	1,230	1,318	1,421
営業利益(損失)	735,406	60,443	97,870	(2,181)	14,711	168,498	143,979	75,703	63,983	22,280	1,119	(18,310)
税金等調整前当期純利益(損失)	737,340	60,602	99,579	(7,768)	9,637	169,220	144,414	75,328	55,775	14,936	(23,010)	(22,919)
当期純利益(損失)	446,843	36,726	71,924	(9,033)	7,543	106,271	91,263	48,006	61,601	8,297	(41,554)	(19,938)
包括利益 ³	449,617	36,954	69,598	(4,751)	-	-	-	-	-	-	-	-
国内売上高	2,084,974	171,364	182,165	162,609	208,871	323,946	313,816	262,532	232,678	242,318	190,513	186,516
海外売上高	5,617,800	461,727	486,557	256,028	299,211	582,146	538,159	411,154	403,032	287,336	270,067	231,309
減価償却費 ⁴	294,415	24,198	17,707	20,002	23,068	21,413	18,820	19,170	21,463	24,963	27,374	26,294
設備投資額 ⁵	481,093	39,541	39,140	14,919	18,108	22,703	27,129	13,335	9,876	11,007	12,359	30,946
研究開発費	991,678	81,506	70,568	54,074	60,988	66,073	56,962	49,182	43,889	44,150	50,123	53,827
総資産	9,534,140	783,611	809,205	696,352	668,998	792,818	770,514	663,243	644,320	561,632	524,901	556,915
純資産 ⁶	7,283,161	598,603	584,802	523,370	529,265	545,245	469,811	376,900	332,165	275,800	252,904	307,579
従業員数(人)		10,684	10,343	10,068	10,391	10,429	9,528	8,901	8,864	8,870	10,053	10,171
	米ドル						円					
1株当たり当期純利益(損失): ⁷												
1株当たり当期純利益(損失)	\$ 2.49	¥ 205.04	¥ 401.73	¥ (50.47)	¥ 42.15	¥ 594.01	¥ 511.27	¥ 267.61	¥ 343.63	¥ 46.37	¥ (238.57)	¥ (113.85)
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 ⁸	2.49	204.72	401.10	-	42.07	592.71	509.84	267.32	343.54	45.78	-	-
1株当たり純資産額	39.85	3,275.14	3,198.66	2,859.37	2,896.55	2,989.70	2,573.72	2,112.30	1,863.28	1,543.73	1,456.23	1,756.73
1株当たり配当額	0.97	80.00	114.00	12.00	24.00	125.00	103.00	55.00	45.00	10.00	8.00	8.00
発行済株式総数(単位:千株)		180,611	180,611	180,611	180,611	180,611	180,611	180,611	180,611	180,611	175,698	175,691
株主総数(人)		42,414	44,896	39,285	42,509	43,324	41,289	46,272	60,857	60,873	49,259	37,116
							%					
自己資本当期純利益率(ROE)		6.3	13.3	(1.8)	1.4	21.4	21.8	13.5	20.3	3.1	(14.8)	(6.2)
営業利益率		9.5	14.6	(0.5)	2.9	18.6	16.9	11.2	10.1	4.2	0.2	(4.4)
自己資本比率		74.9	70.8	73.5	77.5	67.5	59.7	56.8	51.6	49.1	48.2	55.2
総資産回転率(回)		0.79	0.89	0.61	0.70	1.16	1.19	1.03	1.05	0.97	0.85	0.65
	米ドル						千円					
従業員1人当たり売上高	\$ 720,964	¥ 59,256	¥ 64,655	¥ 41,581	¥ 48,896	¥ 86,882	¥ 89,418	¥ 75,687	¥ 71,718	¥ 59,713	¥ 45,815	¥ 41,080

1 2004年3月期までは、FPD(Flat Panel Display)製造装置は半導体製造装置に含めております。2008年3月期より、コンピュータ・ネットワークは、電子部品・情報通信機器に含めております。

2 2009年3月期より、FPD製造装置はFPD/PV製造装置に名称変更致しました。太陽電池(PV)製造装置は、FPD/PV製造装置に含まれております。

3 2011年3月期より、ASBJ(企業会計基準委員会)発表の「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号)を適用しております。それに伴い、2010年3月期より包括利益を開示しております。

4 のれん償却額および減損損失は含まれておりません。

5 設備投資額は、有形固定資産の増加分を示しております。

6 2007年3月期より、純資産は「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号)に基づいて開示をしております。2006年3月期以前は株主資本として以前の会計基準に基づき表示しております。

7 2003年3月期より、ASBJ発表の「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。

8 2011年3月期より、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号 2010年6月30日)及び「1株あたり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号 2010年6月30日公表)を適用しております。

なお、2002年3月期、2003年3月期及び2010年3月期は、希薄化の影響はありません。

9 2005年3月期より、半導体製造装置及びFPD製造装置に係る収益の計上基準を、出荷基準から原則として設置完了基準に変更しております。この変更に伴い、2005年3月期は従来の方法によった場合に比べ、売上高は80,956百万円、営業利益、税金等調整前当期純利益はそれぞれ20,541百万円、20,563百万円減少しております。

10 半導体製造装置及びFPD製造装置に係る保証期間中のアフターサービス費用については、従来、支出時の費用として計上してはいたしましたが、2005年3月期より、過去の支出実績を基準にして算出した見積額を製品保証引当金として計上することに変更しております。この変更に伴い、2005年3月期は従来の方法によった場合に比べ、営業利益、税金等調整前当期純利益はそれぞれ635百万円、13,106百万円減少しております。

財務セクション

■ 連結貸借対照表

連結貸借対照表

東京エレクトロン株式会社及び連結子会社
2012年3月31日及び2011年3月31日現在

資産	百万円		千米ドル
	2012	2011	2012
流動資産:			
現金及び現金同等物.....	¥158,776	¥165,051	\$1,931,817
短期投資.....	88,849	120,000	1,081,020
受取手形及び売掛金.....	150,306	136,385	1,828,763
貸倒引当金.....	(1,376)	(1,154)	(16,742)
たな卸資産.....	149,470	168,925	1,818,591
繰延税金資産.....	23,546	27,610	286,482
前払費用及びその他流動資産.....	37,480	27,414	456,016
流動資産合計.....	607,051	644,231	7,385,947
有形固定資産:			
土地.....	26,260	25,773	319,504
建物及び構築物.....	143,462	121,598	1,745,492
機械装置・運搬具及び工具器具備品.....	115,834	104,699	1,409,344
建設仮勘定.....	9,515	19,509	115,768
合計.....	295,071	271,579	3,590,108
減価償却累計額.....	168,186	159,027	2,046,307
有形固定資産合計.....	126,885	112,552	1,543,801
投資その他資産:			
投資有価証券.....	16,082	15,726	195,669
繰延税金資産.....	17,585	20,728	213,955
無形固定資産.....	4,704	4,212	57,233
その他資産.....	15,152	13,787	184,353
貸倒引当金.....	(3,848)	(2,031)	(46,818)
投資その他資産合計.....	49,675	52,422	604,392
資産合計	¥783,611	¥809,205	\$9,534,140

連結財務諸表注記参照

負債及び純資産	百万円		千米ドル
	2012	2011	2012
流動負債:			
短期借入金.....	¥ 4,403	¥ 7,996	\$ 53,572
支払手形及び買掛金.....	58,243	63,766	708,639
前受金.....	26,373	31,925	320,878
未払法人税等.....	4,289	25,328	52,184
賞与引当金.....	8,646	11,131	105,195
製品保証引当金.....	8,904	7,594	108,334
未払費用及びその他流動負債.....	13,936	20,298	169,558
流動負債合計.....	124,794	168,038	1,518,360
退職給付引当金	55,266	52,826	672,418
その他固定負債	4,948	3,539	60,201
負債合計.....	185,008	224,403	2,250,979
偶発債務			
純資産:			
株主資本			
資本金、普通株式.....	54,961	54,961	668,707
授権株式数: 300,000,000株 発行済株式総数: 2012年及び2011年3月31日現在 180,610,911株			
資本剰余金.....	78,023	78,046	949,300
利益剰余金.....	471,186	457,658	5,732,888
自己株式.....	(9,748)	(10,484)	(118,603)
2012年3月31日現在 1,446,079株 2011年3月31日現在 1,554,231株			
その他の包括利益累計額			
その他有価証券評価差額金.....	3,576	2,807	43,509
繰延ヘッジ損益.....	(51)	(12)	(621)
為替換算調整勘定.....	(11,158)	(10,234)	(135,759)
新株予約権	1,157	1,499	14,077
少数株主持分	10,657	10,561	129,663
純資産合計.....	598,603	584,802	7,283,161
負債及び純資産合計	¥783,611	¥809,205	\$9,534,140

財務セクション

■ 連結損益計算書 | ■ 連結包括利益計算書

連結損益計算書

東京エレクトロン株式会社及び連結子会社
2012年3月期及び2011年3月期

	百万円		千米ドル
	2012	2011	2012
売上高	¥ 633,091	¥ 668,722	\$7,702,774
売上原価	421,646	433,964	5,130,137
売上総利益	211,445	234,758	2,572,637
販売費及び一般管理費	151,002	136,888	1,837,231
営業利益	60,443	97,870	735,406
その他収益(費用):			
受取利息及び受取配当金	1,010	696	12,289
開発補助金収入	1,131	3,027	13,761
貸倒引当金繰入額	(1,848)	0	(22,485)
貸倒引当金戻入額	-	1,892	-
固定資産売却益	566	34	6,886
償却債権取立益	1,437	-	17,484
事業再編損失	(849)	-	(10,330)
投資有価証券評価損	(817)	(74)	(9,940)
閉鎖拠点維持管理費用	(112)	(186)	(1,363)
災害による損失	(936)	(1,114)	(11,388)
工場移転費用	(144)	(1,839)	(1,752)
その他一純額	721	(727)	8,772
税金等調整前当期純利益	60,602	99,579	737,340
法人税等:			
法人税、住民税及び事業税	15,023	29,483	182,784
法人税等調整額	8,400	(2,712)	102,202
少数株主損益調整前当期純利益	37,179	72,808	452,354
少数株主利益	453	884	5,511
当期純利益	¥ 36,726	¥ 71,924	\$ 446,843

1株当たり情報:

	円		米ドル
当期純利益	¥ 205.04	¥ 401.73	\$ 2.49
潜在株式調整後当期純利益	204.72	401.10	2.49
純資産額	3,275.14	3,198.66	39.85
配当金	80.00	114.00	0.97

連結財務諸表注記参照

連結包括利益計算書

東京エレクトロン株式会社及び連結子会社
2012年3月期及び2011年3月期

	百万円		千米ドル
	2012	2011	2012
少数株主損益調整前当期純利益	¥37,179	¥72,808	\$452,354
その他の包括利益:			
その他有価証券評価差額金	769	303	9,356
繰延ヘッジ損益	(69)	72	(839)
為替換算調整勘定	(925)	(3,585)	(11,254)
その他の包括利益合計	(225)	(3,210)	(2,737)
包括利益	36,954	69,598	449,617
(内訳)			
親会社株主に係る包括利益	36,532	68,732	444,482
少数株主に係る包括利益	422	866	5,135

連結財務諸表注記参照

財務セクション

■ 連結株主資本等変動計算書 ■ 連結キャッシュ・フロー計算書

連結株主資本等変動計算書

東京エレクトロン株式会社及び連結子会社
2012年3月期及び2011年3月期

	百万円									
	株主資本				その他の包括利益累計額					
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	その他 有価証券 評価差額金	繰延 ヘッジ 損益	為替換算 調整勘定	新株 予約権	少数株主 持分	純資産合計
2010年4月1日残高.....	¥54,961	¥78,034	¥393,970	¥(10,900)	¥2,504	¥(68)	¥(6,683)	¥1,578	¥9,974	¥523,370
剰余金の配当.....	-	-	(8,236)	-	-	-	-	-	-	(8,236)
当期純利益.....	-	-	71,924	-	-	-	-	-	-	71,924
自己株式の取得.....	-	-	-	(37)	-	-	-	-	-	(37)
自己株式の処分.....	-	12	-	453	-	-	-	-	-	465
株主資本以外の項目の連結 会計年度中の変動額(純額).....	-	-	-	-	303	56	(3,551)	(79)	587	(2,684)
2011年3月31日残高.....	¥54,961	¥78,046	¥457,658	¥(10,484)	¥2,807	¥(12)	¥(10,234)	¥1,499	¥10,561	¥584,802
剰余金の配当.....	-	-	(23,102)	-	-	-	-	-	-	(23,102)
当期純利益.....	-	-	36,726	-	-	-	-	-	-	36,726
自己株式の取得.....	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-	(12)
自己株式の処分.....	-	(23)	(96)	748	-	-	-	-	-	629
株主資本以外の項目の連結 会計年度中の変動額(純額).....	-	-	-	-	769	(39)	(924)	(342)	96	(440)
2012年3月31日残高.....	¥54,961	¥78,023	¥471,186	¥(9,748)	¥3,576	¥(51)	¥(11,158)	¥1,157	¥10,657	¥598,603

	千ドル									
	株主資本				その他の包括利益累計額					
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	その他 有価証券 評価差額金	繰延 ヘッジ 損益	為替換算 調整勘定	新株 予約権	少数株主 持分	純資産合計
2011年3月31日残高.....	\$668,707	\$949,580	\$5,568,293	\$(127,558)	\$34,153	\$(146)	\$(124,516)	\$18,238	\$128,494	\$7,115,245
剰余金の配当.....	-	-	(281,080)	-	-	-	-	-	-	(281,080)
当期純利益.....	-	-	446,843	-	-	-	-	-	-	446,843
自己株式の取得.....	-	-	-	(146)	-	-	-	-	-	(146)
自己株式の処分.....	-	(280)	(1,168)	9,101	-	-	-	-	-	7,653
株主資本以外の項目の連結 会計年度中の変動額(純額).....	-	-	-	-	9,356	(475)	(11,243)	(4,161)	1,169	(5,354)
2012年3月31日残高.....	\$668,707	\$949,300	\$5,732,888	\$(118,603)	\$43,509	\$(621)	\$(135,759)	\$14,077	\$129,663	\$7,283,161

連結財務諸表注記参照

連結キャッシュ・フロー計算書

東京エレクトロン株式会社及び連結子会社
2012年3月期及び2011年3月期

	百万円		千ドル
	2012	2011	
営業活動によるキャッシュ・フロー:			
税金等調整前当期純利益.....	¥ 60,602	¥ 99,579	\$ 737,340
減価償却費.....	24,198	17,707	294,415
のれん償却額.....	-	242	-
退職給付引当金の増加額.....	2,446	2,317	29,760
貸倒引当金の増加(減少)額.....	2,111	(4,341)	25,684
賞与引当金の増加(減少)額.....	(2,506)	5,087	(30,490)
製品保証引当金の増加額.....	1,343	2,352	16,340
受取利息及び受取配当金.....	(1,010)	(696)	(12,289)
受取手形及び売掛金の増加額.....	(15,540)	(13,319)	(189,074)
たな卸資産の(増加)減少額.....	16,023	(36,533)	194,951
未収消費税等の(増加)減少額.....	1,508	(8,025)	18,348
未払消費税等の増加(減少)額.....	(2,417)	2,305	(29,408)
支払手形及び買掛金の増加(減少)額.....	(5,807)	1,667	(70,653)
前受金の増加(減少)額.....	(4,567)	9,575	(55,566)
破産更生債権等の(増加)減少額.....	(1,890)	5,303	(22,995)
その他一純額.....	1,912	6,902	23,263
小計.....	76,406	90,122	929,626
利息及び配当金の受取額.....	978	746	11,900
利息の支払額.....	(43)	(46)	(523)
法人税等の支払額.....	(47,629)	(7,583)	(579,499)
営業活動によるキャッシュ・フロー.....	29,712	83,239	361,504
投資活動によるキャッシュ・フロー:			
定期預金及び短期投資の預入等による支出.....	(284,500)	(360,000)	(3,461,492)
定期預金及び短期投資の払戻等による収入.....	315,500	360,000	3,838,667
有形固定資産の取得による支出.....	(36,010)	(33,542)	(438,131)
有形固定資産の売却による収入.....	1,102	509	13,408
無形固定資産の取得による支出.....	(2,140)	(926)	(26,037)
その他一純額.....	(2,304)	(1,923)	(28,033)
投資活動によるキャッシュ・フロー.....	(8,352)	(35,882)	(101,618)
財務活動によるキャッシュ・フロー:			
短期借入金の純増加(減少)額.....	(3,594)	2,891	(43,728)
自己株式の純(増加)減少額.....	(12)	428	(146)
配当金の支払額.....	(23,102)	(8,236)	(281,080)
その他一純額.....	(627)	(320)	(7,629)
財務活動によるキャッシュ・フロー.....	(27,335)	(5,237)	(332,583)
現金及び現金同等物に係る換算差額.....	(300)	(1,009)	(3,650)
現金及び現金同等物の純増加(減少)額.....	(6,275)	41,111	(76,347)
現金及び現金同等物期首残高.....	165,051	123,940	2,008,164
現金及び現金同等物期末残高.....	¥ 158,776	¥ 165,051	\$ 1,931,817

連結財務諸表注記参照

連結財務諸表注記

1. 連結財務諸表作成の基本事項

添付の東京エレクトロン株式会社(以下「当社」)及び子会社(以下、総称として「東京エレクトロン」)の連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し、金融商品取引法に基づく有価証券報告書に掲載された連結財務諸表に基づいて作成されております。我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準は、その適用及び開示に関して、国際財務報告基準とは異なっております。

当社は連結決算手続上必要とされる修正を勘案した上で、国際財務報告基準若しくは米国にて一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して作成された在外子会社の財務諸表を利用して、連結財務諸表を作成しています。

また、添付の連結財務諸表は、我が国の法定連結財務諸表を再編成し、英訳したものであります。我が国の法定連結財務諸表に含まれる補足情報の一部は、添付の連結財務諸表に記載されておりません。

米国ドル金額は、読者の便宜のために、2012年3月期の期末日レートである1ドル=82.19円で換算しております。この換算は、円貨がそのレートで米国ドルに換金できることを意味しておりません。

2. 重要な会計方針

(a) 連結基準

本連結財務諸表は、2012年及び2011年期末における当社及び子会社それぞれ30社及び32社を連結対象としております。

20%以上50%以下の株式を所有する会社に対する投資は、持分法により評価しております。

連結会社間の重要な債権債務・内部取引・未実現損益は、全て消去されております。

また、連結子会社の事業年度は、3社を除き全て当社の事業年度と一致しております。この3社の事業年度は12月31日で終了しますが、連結決算日である3月31日までの3ヶ月間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っております。

(b) 外貨換算

外貨建債権債務は、連結決算日の取引レートにより日本円に換算しており、その結果生じた換算差額は損益に含めております。ただし、為替予約が付されている外貨建債権債務等については、振当処理を行っております。

収益ならびに費用勘定は、概ね取引発生日の取引レートによって日本円に換算しております。

また、在外子会社の資産及び負債は、各期末日レートで日本円に換算しております。ただし、株主資本については、取得時レートによって換算しております。在外

子会社の収益ならびに費用勘定は、期中平均レートにより換算しております。その結果生じた換算差額は、純資産の部のその他の包括利益累計額及び少数株主持分に表示されております。

(c) 現金及び現金同等物

連結キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物は、現預金及び取得時から3ヶ月以内に満期が到来する流動性の高い投資からなっております。

(d) 短期投資

短期投資は、満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び安全性の高い金融商品から構成されております。

(e) 投資有価証券

東京エレクトロンでは、その保有目的に応じて、投資有価証券を売買目的、満期保有目的、あるいはその他有価証券に分類しております。東京エレクトロンは、売買目的の有価証券は保有しておりません。なお、主として償却原価法にて満期保有目的の有価証券を計上しております。その他有価証券のうち、市場性のある有価証券は連結決算日における公正価値で評価され、未実現損益の変動は適用される税効果控除後の金額でその他の包括利益累計額として純資産の部に表示されております。その他有価証券のうち、市場性のない有価証券は、総平均法による原価法で評価されております。

売却された投資有価証券の原価は、総平均法により算定されております。

(f) たな卸資産

原材料以外のたな卸資産は、個別法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しており、原材料は、主として移動平均法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。

(g) 有形固定資産

有形固定資産は、取得原価で表示されております。建物及び構築物、機械装置・運搬具及び工具器具備品の減価償却については、当社及び国内子会社は定率法で計算されております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法で計算されております。在外連結子会社の減価償却は、主として定額法で計算されております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物	2～60年
機械装置・運搬具及び工具器具備品	2～17年

(h) 無形固定資産

主としてソフトウェア及びのれんで構成される無形固定資産は、定額法によって償却しております。なお、自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間(2～5年)に基づく定額法を採用しております。のれんについては、個別案件ごとに判断し、20年以内の合理的な年数で償却しております。

(i) 固定資産の減損

東京エレクトロンは、事業の用に供している固定資産の帳簿価額の評価を実施しています。

固定資産帳簿価額の減損が認められた場合、帳簿価額が売却価値と使用価値のいずれか高い方である回収可能価額を超えた額を損失として認識します。売却価値は公正価額から処分費用を減額した金額、使用価値は個々の資産または資産グループの継続的使用及び使用後の処分から得られる将来キャッシュ・フローの割引現在価値の金額によってそれぞれ算定されます。

(j) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収の可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(k) 退職給付引当金

当社及び国内子会社は、従業員の退職給付に備えるため、退職給付債務の見込額及び年金資産の公正価値に基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。過去勤務債務は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(4年)による定額法により按分した額を費用処理しております。また、数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(4年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生翌連結会計年度から費用処理しております。

当社及び国内子会社は、従業員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

なお、当社及び一部国内子会社は、2005年3月末日をもって役員退職慰労金制度を廃止することといたしました。これに伴い、2005年6月開催の定時株主総会において、各役員の見込額から2005年3月末日までの在任期間に対応する退職慰労金を各役員の見込額から支給することを決議し、支給する金額及び方法等については、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任したため、当該支給見込額を引当計上しております。注記9に記載のとおり、役員退職慰労引当金は、連結貸借対照表上の退職給付引当金に含まれます。

連結財務諸表注記

(l) 製品保証引当金

東京エレクトロンの製品は通常製品保証が付されており、製品保証期間中のアフターサービスに対する費用の支出に備えるため、過去の支出実績に基づき将来の支出見込額を、収益認識時に計上しております。

(m) リース

2008年3月期以前は、当社及び国内子会社は、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じ、オペレーティング・リースとして会計処理しておりました。

2009年3月期より、当社及び国内子会社は、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 企業会計基準第13号)、及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第16号)を適用しております。その結果、当社及び国内子会社は2008年4月1日以後に開始したファイナンス・リース取引については、リース資産として計上し、当該リース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(n) デリバティブ及びヘッジ会計

当社及び一部国内子会社が利用しているデリバティブ取引は、為替変動によるリスクの回避を目的として、外貨建取引の成約高の範囲に限られており、投機的な取引は行っておりません。

デリバティブ金融商品は連結貸借対照表上公正価値で評価され、未実現損益の変動は繰延ヘッジ会計の要件を満たす場合を除いては利益又は損失として計上されております。税効果控除後の繰延ヘッジ損益は、純資産の部のその他包括利益累計額に表示されております。ヘッジ会計の要件を満たした外国為替先物予約契約によりヘッジされている受取債権及び支払債務は、当該予約レートで換算されております。

(o) 法人税等

東京エレクトロンは、資産及び負債の財務報告上の金額と税務上の評価額との差額について繰延税金資産及び負債を認識しており、それらは当該差額が解消すると期待される時点で適用される税率と税法を用いて計算されております。

(p) 収益の計上基準

半導体製造装置及びFPD (Flat Panel Display) / PV (Photovoltaic cell) 製造装置の収益の計上基準については、原則として設置完了基準によっております。重要な据付作業を要さない装置については、出荷基準によって収益を認識しております。電子部品を含むその他の製品については、出荷基準によって収益を認識しております。有償保守サービスについては、メンテナンス契約期間にわたって収益を認識しております。

(q) 1株当たり情報

1株当たり当期純利益及び純資産額は、各年の加重平均株式数に基づき計算されております。

1株当たり配当額は、3月31日に終了する決算期に係る配当金を発生主義に基づき計算しており、3月31日以降に決議された配当金を含んでおります。

(r) 研究開発費

研究開発費は、発生時に費用として処理しております。2012年及び2011年3月期の研究開発費は、それぞれ81,506百万円(991,678千ドル)及び70,568百万円となっております。

(s) 組替表示

過年度の連結財務諸表は、2012年3月期の表示に合わせて組替表示されております。

3. 会計方針の変更

(a) 1株当たり当期純利益に関する会計基準

2012年3月期より、当社は、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会 企業会計基準第2号 2010年6月30日)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第4号 2010年6月30日公表分)を適用しております。潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストック・オプションの公正な評価額のうち、将来企業に提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。

(b) 会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準

2012年3月期以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、当社及び国内子会社は、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準委員会 企業会計基準第24号)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第24号)を適用しております。これによる損益に与える影響はありません。

(c) 資産除去債務に関する会計基準

2011年3月期より、当社及び国内子会社は、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準委員会 企業会計基準第18号)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第21号)を適用しております。これによる損益に与える影響は、軽微であります。

(d) セグメント情報及び関連情報の開示に関する会計基準

2011年3月期より、当社は「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 企業会計基準第17号)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第20号)を適用しております。これによりマネジメント・アプローチに基づくセグメント情報の開示を行っております。結果、当社は報告セグメントの単位および報告セグメントの利益を変更しております。

(e) 包括利益の表示に関する会計基準

2011年3月期より、当社は、「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 企業会計基準第25号)を適用しております。これにより当社は2011年3月期より連結包括利益計算書を作成しております。

(f) 連結財務諸表に関する会計基準

2011年3月期より、当社は、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 企業会計基準第22号)に基づき、「財務諸表の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第5号)を適用しております。これにより、連結損益計算書に「少数株主損益調整前当期純利益」の科目名にて小計額を追加しております。

■ 連結財務諸表注記

連結財務諸表注記

4. 有価証券

2012年及び2011年3月31日現在のその他有価証券のみで構成されている投資有価証券の内訳は次のとおりであります。

	百万円	
	取得原価	連結貸借対照表計上額
2012:		
固定資産		
時価のあるもの		
株式	¥ 9,212	¥14,699
時価のないもの		
非上場株式	485	473
その他	910	910
合計	¥10,607	¥16,082

	百万円	
	取得原価	連結貸借対照表計上額
2011:		
流動資産	¥232,058	¥232,058
固定資産		
時価のあるもの		
株式	¥ 9,763	¥ 14,445
時価のないもの		
非上場株式	365	370
その他	911	911
合計	¥ 11,039	¥ 15,726

	千米ドル	
	取得原価	連結貸借対照表計上額
2012:		
固定資産		
時価のあるもの		
株式	\$112,082	\$178,842
時価のないもの		
非上場株式	5,901	5,755
その他	11,072	11,072
合計	\$129,055	\$195,669

2012年3月31日現在において流動資産に区分されている満期保有目的の債券は、211,790百万円(2,576,835千米ドル)であります。2011年3月31日現在には満期保有目的の債券はありません。

連結貸借対照表上の短期投資と、2012年3月期の満期保有目的の債券及び2011年3月期のその他有価証券の差額は、次のとおりであります。

	百万円		千米ドル
	2012	2011	2012
満期保有目的債券(流動)	¥ 211,790	¥ —	\$ 2,576,835
その他有価証券(流動)	—	232,058	—
満期日又は償還日までの期間が3ヶ月以内の安全性の高い金融商品	(132,790)	(142,058)	(1,615,647)
満期日までの期間が3ヶ月超の定期預金	9,849	30,000	119,832
短期投資	¥ 88,849	¥ 120,000	\$ 1,081,020

5. たな卸資産

2012年及び2011年3月31日現在のたな卸資産の内訳は、次のとおりであります。

	百万円		千米ドル
	2012	2011	2012
製品	¥101,790	¥111,918	\$1,238,472
仕掛品・原材料・貯蔵品	47,680	57,007	580,119
合計	¥149,470	¥168,925	\$1,818,591

2012年及び2011年3月期の連結損益計算書の「売上原価」には、たな卸資産評価損1,115百万円(13,566千米ドル)及び1,202百万円が含まれています。

6. 固定資産の減損

固定資産の減損損失認識の判定においては、原則として、事業用資産については損益管理を合理的に行える事業単位を基礎とした区分に基づき資産のグルーピングを行っております。また、非事業用資産及び遊休資産については、個別に回収可能性の評価を実施しております。

7. 担保提供資産

2012年及び2011年3月31日現在、東京エレクトロンが担保に供している資産はありません。

8. 短期借入金

東京エレクトロンの短期借入金の2012年及び2011年3月31日現在の平均利率は、それぞれ0.40%、0.39%であります。

2012年3月31日現在における当座貸越契約及び貸出コミットメントの残高は、150,248百万円(1,828,057千米ドル)であります。

9. 退職給付引当金

当社及び国内子会社は、大多数の従業員を対象として、確定給付年金制度(キャッシュバランスプラン及び非拠出制の退職給付一時金制度)を設けております。

これらの制度において、給付金額は勤務期間及びその他の事由に基づいて決定されております。

キャッシュバランスプランにおいて、従業員は解雇以外の事由で退職した場合、年金あるいは一時金を受給します。キャッシュバランスプランのもとでは、対象者の個人別仮想口座において、毎年の掛金及び市場連動金利に基づいた給付額が計算されて積み立てられます。非拠出制の退職一時金制度においては、解雇以外の事由で退職した従業員が一時金を受給します。一部の海外子会社は、非拠出制の退職給付一時金制度を採用しており、解雇以外の事由で退職した従業員は、年金あるいは一時金を受給します。

2012年及び2011年3月31日現在の退職給付債務に関する事項は、次のとおりであります。

	百万円		千米ドル
	2012	2011	2012
退職給付債務	¥(94,369)	¥(89,350)	\$(1,148,181)
年金資産	45,139	41,282	549,203
未積立退職給付債務	(49,230)	(48,068)	(598,978)
未認識数理計算上の差異	(1,809)	(90)	(22,010)
未認識過去勤務債務	—	25	—
純額	(51,039)	(48,133)	(620,988)
連結貸借対照表計上額			
前払年金費用(注1)	3,607	4,097	43,886
退職給付引当金(注2)	(54,646)	(52,230)	(664,874)
純額	¥(51,039)	¥(48,133)	\$ (620,988)

注: 1. 2012年及び2011年3月期の前払年金費用は、連結貸借対照表の「その他資産」に含まれております。
2. 役員退職慰労引当金(2012年:620百万円(7,544千米ドル)、2011年:596百万円)は含まれておりません。

退職給付費用に関する事項は、次のとおりであります。

	百万円		千米ドル
	2012	2011	2012
勤務費用	¥5,597	¥5,474	\$68,099
利息費用	1,768	1,666	21,511
期待運用収益	(814)	(767)	(9,904)
数理計算上の差異の費用処理額	401	286	4,879
過去勤務債務の費用処理額	25	100	304
合計	¥6,977	¥6,759	\$84,889

退職給付債務等の計算の基礎に関する事項は、次のとおりであります。

	2012及び2011
退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準
割引率	2.00%
期待運用収益率	2.00%
数理計算上の差異の処理年数	4年
過去勤務債務の額の処理年数	4年

連結財務諸表注記

10. 法人税等

2012年及び2011年3月31日現在の東京エレクトロンの繰延税金資産・負債の主な内訳は、次のとおりであります。

	百万円		千米ドル
	2012	2011	2012
繰延税金資産			
退職給付引当金.....	¥ 19,538	¥21,172	\$ 237,717
試験研究費の繰越税額控除.....	12,564	5,910	152,865
たな卸資産に係る未実現利益.....	9,161	10,309	111,461
たな卸資産評価損.....	4,749	4,716	57,781
製品保証引当金.....	2,971	2,795	36,148
賞与引当金.....	2,954	4,471	35,941
税務上の繰越欠損金.....	1,609	1,475	19,577
貸倒引当金.....	1,035	690	12,593
その他.....	6,994	11,768	85,095
繰延税金資産小計.....	61,575	63,306	749,178
評価性引当額.....	(15,134)	(9,031)	(184,134)
繰延税金資産合計.....	46,441	54,275	565,044
繰延税金負債			
在外子会社の留保利益.....	(3,760)	(3,087)	(45,748)
その他有価証券評価差額金.....	(1,981)	(1,916)	(24,103)
前払年金費用.....	(1,200)	(1,635)	(14,600)
特別償却準備金.....	(1,084)	(8)	(13,189)
その他.....	(748)	(1,524)	9,100
繰延税金負債合計.....	(8,773)	(8,170)	(106,740)
繰延税金資産の純額.....	¥ 37,668	¥46,105	\$ 458,304

2012年及び2011年3月期の繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	百万円		千米ドル
	2012	2011	2012
流動資産-繰延税金資産.....	¥23,546	¥27,610	\$286,482
固定資産-繰延税金資産.....	17,585	20,728	213,955
流動負債-その他.....	(1)	(1)	(12)
固定負債-その他.....	(3,462)	(2,232)	(42,122)

当社及び国内全額出資子会社は、連結納税制度を適用しております。

繰延税金資産の回収可能性は、将来減算一時差異の解消が予定される期間の将来課税所得の水準に依存しております。繰延税金資産の回収可能性の判断において、経営者は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて、予定される繰延税金負債の戻入、将来の課税所得の見通し、税務戦略及び税務上の繰越欠損金の推移等を考慮しております。

経営者は、2012年及び2011年3月31日時点の東京エレクトロンの評価性引当額控除後の繰延税金資産に対して、過去の課税所得や、繰延税金資産が控除可能な期間における将来の課税所得を踏まえ、回収可能であると判断しております。

法人税、住民税、事業税を合計した2012年及び2011年3月期における当社の法定実効税率は、40.69%となっております。2011年12月2日付で税制改正が公表されたことに伴い、法定実効税率は2012年4月1日から2015年3月31日までのものは38.01%、2015年4月1日以降については35.64%にそれぞれ変更されております。当該税制改正に基づき、当社及び国内子会社の2012年3月31日現在の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、回収又は支払が見込まれる期間が2012年4月1日から2015年3月31日までのものは38.01%、2015年4月1日以降のものについては35.64%にそれぞれ変更されております。その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が3,310百万円（40,273千米ドル）減少し、2012年3月期に計上された法人税等調整額は3,587百万円（43,643千米ドル）増加しております。

2012年及び2011年3月期における東京エレクトロンの法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳は、次のとおりであります。

	2012	2011
国内の法定実効税率.....	40.69 %	40.69 %
(調整)		
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正.....	5.92	-
試験研究費等の税額控除.....	(5.20)	(7.22)
税率差異による差額.....	(4.04)	(2.26)
その他.....	1.28	(4.33)
税効果会計適用後の法人税等の負担率.....	38.65 %	26.88 %

11. 純資産

純資産は、株主資本、その他の包括利益累計額、新株予約権及び少数株主持分の4区分で構成されております。

我が国の法令及び規則のもとでは、新株の払込金の全額を資本金とすることが求められておりますが、取締役会決議により、発行価額の50%を超えない金額を資本剰余金に含まれる資本準備金に組み入れることも認められております。

剰余金の配当を行う場合、資本金の25%に相当する額が資本準備金及び利益準備金の合計額を超える時は、その超過額または配当の10%に相当する額のうちいずれか少ない方の金額を、資本準備金あるいは利益準備金として計上することが要求されております。利益準備金は、連結財務諸表上、利益剰余金に含まれております。

また、原則として、利益準備金及び資本準備金を欠損金填補のために使用するためには、いずれも株主総会の決議を要します。

資本準備金及び利益準備金から配当を実施することはできません。全ての資本準備金と利益準備金はそれぞれその他資本剰余金とその他利益剰余金に振り替えることができ、これらを配当に使用することができます。

当社の分配可能額は、法令及び規則に従い、当社の個別財務諸表に基づき算出されております。

当社は、2006年6月23日に開催された定時株主総会において、法令及び規則に従い、取締役会の決議により中間配当と期末配当以外にも配当を実施できるよう、定款の変更を決議致しました。

2012年5月15日開催の取締役会において、4,837百万円（58,851千米ドル）の配当の実施が決議されました。この配当は、2012年3月31日現在の連結財務諸表には計上されておらず、当該取締役会決議日が属する事業年度において計上されます。

連結財務諸表注記

12. その他包括利益(損失)

2012年3月期におけるその他包括利益の内訳は、次のとおりであります。

	百万円 2012	千米ドル 2012
その他有価証券評価差額金		
当期発生額	¥ 302	\$ 3,674
組換調整額	531	6,461
税効果調整前	833	10,135
税効果額	(64)	(779)
その他有価証券評価差額金	769	9,356
繰延ヘッジ損益		
当期発生額	(9)	(109)
組換調整額	(101)	(1,229)
税効果調整前	(110)	(1,338)
税効果額	41	499
繰延ヘッジ損益	(69)	(839)
為替換算調整勘定		
当期発生額	(925)	(11,254)
組換調整額	-	-
税効果調整前	(925)	(11,254)
税効果額	-	-
為替換算調整勘定	(925)	(11,254)
その他の包括利益(損失)合計	¥(225)	\$ (2,737)

当期または当期以前に発生したその他包括利益のうち、当期純利益に組替られた金額は、2012年3月期より開示が要請されています。

13. 株式報酬制度

ストック・オプション制度

東京エレクトロンでは、1999年3月に終了した年度より、役員及び幹部従業員へのストック・オプション制度を採用しております。この制度において付与されたストック・オプションの行使期間は、付与後8年から20年でありますが、付与後2年間または3年間の行使は制限されております。

2012年3月期には、234,200株が株主総会決議のもと、1円の行使価格にて付与されております。この制度において付与されたストック・オプションの行使期間は付与後20年でありますが、付与後3年間の行使は制限されております。2011年3月期には、ストック・オプションは付与されておられません。

国内上場子会社である東京エレクトロンデバイス(株)は、2005年3月期より役員及び幹部従業員に対するストック・オプション制度を採用しております。

2012年及び2011年3月31日時点のストック・オプション残高及び行使可能残高の概要は、以下のとおりです。

東京エレクトロン(株)	2012			2011	
	株数	加重平均行使価格		株数	加重平均
		円	ドル		行使価格
期首残高	1,296,800	¥ 5,086	\$ 61.88	1,779,100	¥ 5,720
付与	234,200	1	0.01	-	-
行使	111,100	1	0.01	67,100	1
失効	586,600	6,786	82.56	415,200	8,625
期末残高	833,300	3,139	38.19	1,296,800	5,086
行使可能残高	599,100	4,365	53.11	1,120,500	5,886

東京エレクトロンデバイス(株)	2012			2011	
	株数	加重平均行使価格		株数	加重平均
		円	ドル		行使価格
期首残高	650	¥308,698	\$3,755.91	650	¥308,698
付与	-	-	-	-	-
行使	-	-	-	-	-
失効	-	-	-	-	-
期末残高	650	308,698	3,755.91	650	308,698
行使可能残高	650	308,698	3,755.91	650	308,698

14. リース

注記2(m)に記載のとおり、2009年3月期より、当社及び国内子会社は、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 企業会計基準第13号)、及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第16号)を適用しております。当基準においては、2008年3月期以前に開始されたファイナンス・リースは、継続して通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によることが認められております。2008年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に関しては、キャピタル・リースとして処理した場合における取得価額、減価償却累計額、リース債務及び減価償却費の予測数値は、2012年及び2011年3月期それぞれ、次のとおりであります。

連結貸借対照表に記載されていないリース資産:

	百万円 2012	2011	千米ドル 2012
取得価額相当額	¥286	¥947	\$3,480
減価償却累計額相当額	216	690	2,628
期末残高相当額	¥ 70	¥257	\$ 852

当該所有権移転外ファイナンス・リースに係る未経過リース料:

	百万円 2012	2011	千米ドル 2012
1年内	¥48	¥139	\$584
1年超	22	118	268
合計	¥70	¥257	\$852

オペレーティング・リースとして処理されたファイナンス・リースに関わるリース支払額は、それぞれのリース資産のリース期間にて定額法で計算した減価償却費相当額と概ね同額であると想定され、2012年及び2011年3月期において、それぞれ総額97百万円(1,180千米ドル)及び158百万円でした。

オペレーティング・リースに係る未経過リース料:

	百万円 2012	2011	千米ドル 2012
1年内	¥2,013	¥1,984	\$24,492
1年超	2,905	4,361	35,345
合計	¥4,918	¥6,345	\$59,837

■ 連結財務諸表注記

連結財務諸表注記

15. 金融商品

金融商品に対する取組方針及びリスク管理体制

東京エレクトロンは、資金運用については短期的な預金並びに安全性の高い金融商品に限定し、また、資金調達については主に銀行借入や売掛債権流動化によっております。

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクについては、当社の社内規程である「信用限度規程」に従い、取引先ごとの与信枠の管理を行うとともに、債権期日管理及び残高管理を行っております。また、主な取引先の信用状況については、定期的に把握しております。

短期投資は、定期預金及び安全性の高い金融商品から構成されており、信用リスクを軽減するため格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。

投資有価証券は、主に上場株式であるため市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価等の状況を把握しております。

営業債務である短期借入金、支払手形及び買掛金等は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。

営業債務は、流動性リスクに晒されておりますが、資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

デリバティブ取引については、注記16を参照ください。

金融商品の時価等に関する事項

2012年及び2011年3月31日における連結貸借対照表計上額及び時価については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません(注記4を参照下さい)。

2012:	百万円	
	連結貸借 対照表計上	時価 ¹⁾
資産		
現金及び現金同等物.....	¥158,776	¥158,776
短期投資.....	88,849	88,638
受取手形及び売掛金 -貸倒引当金(1,376百万円)控除後.....	148,930	148,930
投資有価証券.....	14,699	14,699
負債		
短期借入金.....	4,403	4,403
支払手形及び買掛金等.....	58,243	58,243
デリバティブ取引(注記16参照)		
ヘッジ会計が適用されていないもの.....	(400)	(400)
ヘッジ会計が適用されているもの.....	(153)	(153)

2011:	百万円	
	連結貸借 対照表計上	時価 ¹⁾
資産		
現金及び現金同等物.....	¥165,051	¥165,051
短期投資.....	120,000	120,000
受取手形及び売掛金 -貸倒引当金(1,154百万円)控除後.....	135,231	135,231
投資有価証券.....	14,445	14,445
負債		
短期借入金.....	7,996	7,996
支払手形及び買掛金等.....	63,766	63,766
デリバティブ取引(注記16参照)		
ヘッジ会計が適用されていないもの.....	327	327
ヘッジ会計が適用されているもの.....	(44)	(44)

2012:	千米ドル	
	連結貸借 対照表計上	時価 ¹⁾
資産		
現金及び現金同等物.....	\$1,931,817	\$1,931,817
短期投資.....	1,081,020	1,078,452
受取手形及び売掛金 -貸倒引当金(16,742千米ドル)控除後.....	1,812,021	1,812,021
投資有価証券.....	178,842	178,842
負債		
短期借入金.....	53,572	53,572
支払手形及び買掛金等.....	708,639	708,639
デリバティブ取引(注記16参照)		
ヘッジ会計が適用されていないもの.....	(4,866)	(4,866)
ヘッジ会計が適用されているもの.....	(1,862)	(1,862)

デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は、純額で表示しております。合計で正味の債務となる項目については、()で表示しております。

注: 1. 金融商品の時価の算定方法並びに短期投資及びデリバティブ取引に関する事項
現金及び預金、受取手形及び売掛金、短期投資、短期借入金、支払手形及び買掛金等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

投資有価証券
市場のある投資有価証券の時価は、取引所の価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、注記4を参照ください。
デリバティブ取引
注記16を参照ください。

2. 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

2012:	百万円	
	1年以内	1年超5年以内
現金及び現金同等物.....	¥158,776	¥ -
短期投資.....	88,849	-
受取手形及び売掛金.....	150,306	-

2011:	百万円	
	1年以内	1年超5年以内
現金及び現金同等物.....	¥165,051	¥ -
短期投資.....	120,000	-
受取手形及び売掛金.....	136,385	-

2012:	千米ドル	
	1年以内	1年超5年以内
現金及び現金同等物.....	\$1,931,817	\$ -
短期投資.....	1,081,020	-
受取手形及び売掛金.....	1,828,763	-

3. 借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額

2012:	百万円		
	1年以内	1年超2年以内	2年超5年以内
短期借入金.....	¥4,403	¥ -	¥ -
リース債務.....	335	267	42

2011:	百万円		
	1年以内	1年超2年以内	2年超5年以内
短期借入金.....	¥7,996	¥ -	¥ -
リース債務.....	127	103	64

2012:	千米ドル		
	1年以内	1年超2年以内	2年超5年以内
短期借入金.....	\$53,572	\$ -	\$ -
リース債務.....	4,076	3,249	511

連結財務諸表注記

16. デリバティブ

東京エレクトロンは、通常の営業活動に伴う外貨建取引及び財務活動に伴う外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを回避する目的で、先物為替予約取引を利用しておりますが、投機的な目的での取引は行っておりません。なお、当社及び一部国内子会社は、取引先の契約不履行による信用リスクを負っておりますが、先物為替予約取引の取引先は信用度の高い銀行であるため、取引先の契約不履行にかかる信用リスクは重要ではないと認識しております。先物為替予約取引の実行及び管理は、社内規程である「金融市場リスク管理規程」に基づき、財務担当部署が行っており、先物為替予約取引の有効性の検証については、半期毎に担当取締役等へ報告されております。

2012年及び2011年3月31日現在のデリバティブの公正価額は、次のとおりであります。

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2012:	百万円		
	契約額	時価	評価損益
売建 米ドル	¥ 9,874	¥(464)	¥(464)
売建 韓国ウォン	701	23	23
買建 米ドル	5,804	41	41
合計	¥16,379	¥(400)	¥(400)

2011:	百万円		
	契約額	時価	評価損益
売建 米ドル	¥ 7,405	¥ (72)	¥ (72)
売建 韓国ウォン	1,235	350	350
買建 米ドル	4,763	49	49
合計	¥13,403	¥327	¥327

2012:	千米ドル		
	契約額	時価	評価損益
売建 米ドル	\$120,136	\$(5,645)	\$(5,645)
売建 韓国ウォン	8,529	280	280
買建 米ドル	70,617	499	499
合計	\$199,282	\$(4,866)	\$(4,866)

注:時価の算定方法は先物為替相場によっております。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

2012: 繰延ヘッジ処理	百万円		千米ドル	
	契約額	時価	契約額	時価
売建 米ドル	¥ 6,879	¥(181)	\$ 83,696	\$(2,203)
売建 韓国ウォン	85	(7)	1,034	(85)
売建 人民元	192	1	2,336	12
買建 米ドル	4,325	17	52,622	207
買建 ユーロ	195	17	2,373	207
合計	¥11,676	¥(153)	\$142,061	\$(1,862)

2011: 繰延ヘッジ処理	百万円	
	契約額	時価
売建 米ドル	¥ 6,411	¥(54)
売建 韓国ウォン	37	11
買建 米ドル	4,099	(1)
合計	¥10,547	¥(44)

先物為替予約取引の契約額は、外貨建受取債権及び支払債務をヘッジするために行なわれ、連結貸借対照表において当該債権債務が予約レートで換算されているものは、次の通りです。

為替予約等の振当処理	時価		
	百万円	2011	千米ドル
2012			2012
売建 米ドル	¥ 58	¥ 90	\$ 705
売建 人民元	9,854	-	119,893
買建 米ドル	65	62	791
合計	¥9,977	¥152	\$121,389

注:時価の算定方法は先物為替相場によっており、外貨建債権債務等に振り当てたデリバティブ取引については、ヘッジ対象と一体として処理されているため、当該デリバティブ取引の時価はヘッジ対象の時価に含めて記載しております。

17. その他収益(費用)

2011年3月期における貸倒引当金戻入益1,892百万円は回収不能と見込んでいた個別の破産更生債権に係る入金に関する収益であります。

2011年3月期における工場移転費用1,839百万円は、エッチング装置事業を移管したことに伴う費用であります。

2012年及び2011年3月期における災害による損失、それぞれ936百万円(11,388千米ドル)及び1,114百万円は、2011年3月11日に発生した東日本大震災に係る費用であり、主に操業停止期間に発生した固定費及び被災地施設の復旧工事費用であります。

2012年3月期における事業再編損失849百万円(10,330千米ドル)は、事業の再編に伴う資産評価減及び処分等の費用であります。

18. セグメント情報

報告セグメントの概要

東京エレクトロンの報告セグメントは、東京エレクトロンの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営者が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

東京エレクトロンは、BU(ビジネスユニット)を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「半導体製造装置」、「FPD/PV(フラットパネルディスプレイ及び太陽電池)製造装置」及び「電子部品・情報通信機器」を報告セグメントとしております。

「半導体製造装置」の製品は、ウェーハ処理工程で使われるコータ/デベロッパ、プラズマエッチング装置、熱処理成膜装置、枚葉成膜装置、洗浄装置、ウェーハ検査工程で使われるウェーハプロバ及びその他半導体製造装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

「FPD/PV製造装置」の製品は、フラットパネルディスプレイ製造用のコータ/デベロッパ、プラズマエッチング/アッシング装置及び薄膜シリコン太陽電池用のプラズマCVD装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

「電子部品・情報通信機器」は、集積回路(IC)を中心とした半導体製品、その他電子部品、コンピュータ・ネットワーク機器、ソフトウェア等の設計・開発・仕入・販売等を行っております。

報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表の作成方法と概ね同一であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。また、共用資産については、各報告セグメントに配分しておりませんが、関連する費用については、合理的な基準に基づき各報告セグメントに配分しております。

連結財務諸表注記

報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

2012年及び2011年3月期の報告セグメント情報は、次のとおりであります。

	報告セグメント				合計	調整額	連結財務 諸表計上額
	半導体 製造装置	FPD/PV 製造装置	電子部品・ 情報通信機器	その他			
百万円							
2012:							
売上高							
外部顧客への売上高	¥477,873	¥69,889	¥84,868	¥ 461	¥633,091	¥ -	¥633,091
セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	1,432	14,565	15,997	(15,997)	-
計	477,873	69,889	86,300	15,026	649,088	(15,997)	633,091
セグメント利益	89,020	2,271	2,312	1,827	95,430	(34,828)	60,602
セグメント資産	262,789	21,295	46,391	1,927	332,402	451,209	783,611
減価償却費	11,282	687	570	170	12,709	11,489	24,198
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	13,518	672	407	36	14,633	28,572	43,205

	報告セグメント				合計	調整額	連結財務 諸表計上額
	半導体 製造装置	FPD/PV 製造装置	電子部品・ 情報通信機器	その他			
百万円							
2011:							
売上高							
外部顧客への売上高	¥511,332	¥66,721	¥90,216	¥ 453	¥668,772	¥ -	¥668,722
セグメント間の内部売上高又は振替高	0	-	1,100	14,908	16,008	(16,008)	-
計	511,332	66,721	91,316	15,361	684,730	(16,008)	668,722
セグメント利益	120,846	6,641	2,907	1,916	132,310	(32,731)	99,579
セグメント資産	239,707	42,812	50,255	2,094	334,868	474,337	809,205
減価償却費	7,369	543	456	354	8,722	8,985	17,707
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	13,182	553	774	28	14,537	26,723	41,260

連結財務諸表注記

	報告セグメント				千米ドル		連結財務 諸表計上額
	半導体 製造装置	FPD/PV 製造装置	電子部品・ 情報通信機器	その他	合計	調整額	
2012:							
売上高							
外部顧客への売上高	\$5,814,247	\$850,335	\$1,032,583	\$ 5,609	\$7,702,774	\$ -	\$7,702,774
セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	17,423	177,211	194,634	(194,634)	-
計	5,814,247	850,335	1,050,006	182,820	7,897,408	(194,634)	7,702,774
セグメント利益	1,083,100	27,631	28,130	22,229	1,161,090	(423,750)	737,340
セグメント資産	3,197,335	259,095	564,436	23,446	4,044,312	5,489,828	9,534,140
減価償却費	137,267	8,359	6,935	2,068	154,629	139,786	294,415
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	164,473	8,176	4,952	438	178,039	347,633	525,672

- 注: 1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社グループの製品等の輸送、機器等のリース及び保険業務等を含んでおります。
2. (1) 2012年及び2011年3月期のセグメント利益の調整額、それぞれ34,828百万円(423,750千米ドル)及び32,731百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれております。2012年及び2011年3月期の全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社における基礎研究又は要素研究等の研究開発費で、それぞれ26,071百万円(317,204千米ドル)及び22,719百万円です。
- (2) 2012年及び2011年3月期のセグメント資産の調整額、それぞれ451,209百万円(5,489,828千米ドル)及び474,337百万円の内容は、各報告セグメントに配分していない現金及び現金同等物、短期投資、建物及び構築物等です。
3. 2012年及び2011年3月期の有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は28,572百万円(347,633千米ドル)及び26,723百万円の内容は、各報告セグメントに配分していない建物及び構築物の設備投資額です。
4. セグメント利益は、連結損益計算書の税金等調整前当期純利益と調整を行っております。

関連情報

(1) 2012年及び2011年3月期の国内及び海外売上高は、次のとおりであります。

	百万円		千米ドル
	2012	2011	2012
売上高			
日本	¥171,364	¥182,165	\$2,084,974
米国	114,951	103,013	1,398,601
韓国	114,218	106,374	1,389,682
台湾	86,882	169,276	1,057,087
その他	145,676	107,894	1,772,430
合計	¥633,091	¥668,722	\$7,702,774

注: 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 2012年及び2011年3月期の地域別有形固定資産残高は、次のとおりであります。

2012:	百万円			千米ドル		
	日本	その他	合計	日本	その他	合計
有形固定資産	¥107,874	¥19,011	¥126,885	\$1,312,495	\$231,306	\$1,543,801
2011:						
有形固定資産	¥ 97,775	¥14,777	¥112,552			

連結財務諸表注記

(3) 主要な顧客ごとの情報

当社の売上高合計の10%以上を占める外部顧客への売上高は、次のとおりであります。

顧客の名称又は氏名	関連するセグメント名	百万円	千米ドル
		2012	2012
Samusung Electronics Co., Ltd.	半導体製造装置、FPD/PV製造装置	¥116,919	\$1,422,545
Intel Corporation	半導体製造装置	90,399	1,099,878

顧客の名称又は氏名	関連するセグメント名	百万円
		2011
Samusung Electronics Co., Ltd.	半導体製造装置、FPD/PV製造装置	¥101,074

注：売上高には、当該顧客と同一の企業集団に属する顧客に対する売上高を含めております。

19. 後発事象

ストック・オプション制度によるストック・オプションの付与

2012年5月15日開催の当社取締役会において、役員及び幹部従業員に対して新株予約権を発行することの承認を求める議案を定時株主総会に付議することを決議いたしました。この新株予約権の発行は、ストック・オプションの実施を目的とするものです。このストック・オプション制度では、行使価格1円(0.01米ドル)で最大53,800株のストック・オプションが当社取締役(社外取締役及び6月22日をもって退任した取締役を除く)に付与され、また、行使価格1円(0.01米ドル)で最大

77,000株のストック・オプションが、2012年3月31日時点の当社執行役員及び2012年6月22日開催の当社定時株主総会終結の時をもって退任となる当社取締役、2012年3月31日時点の当社国内子会社の取締役及び執行役員並びに当社海外子会社の会長・社長・副会長のうち、ストック・オプションの付与を承認する株主総会後に開催された取締役会の決議により必要と認められる者に付与されます。当該ストック・オプションの付与は、2012年6月22日の定時株主総会にて承認されております。

独立監査人の監査報告書

掲載の連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準並びに我が国の金融商品取引法に準拠した有価証券報告書に記載された連結財務諸表を基礎として作成された英文連結財務諸表を、日本語に翻訳したものです。英文連結財務諸表には英文監査報告書が添付されており、その日本語訳は以下のとおりです。



東京エレクトロン株式会社
取締役会 御中

私どもは、添付の東京エレクトロン株式会社及び連結子会社の連結財務諸表、すなわち、2012年及び2011年3月31日現在の連結貸借対照表、並びに同日をもって終了する連結会計年度の連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、及び重要な会計方針その他の注記について監査を行った。

連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

私どもの責任は、私どもが実施した監査に基づいて、連結財務諸表に対する意見を表明することにある。私どもは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は私どもに、倫理基準等に準拠し、連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、私どもの判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、私どもは、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

私どもは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

私どもは、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京エレクトロン株式会社及び連結子会社の2012年及び2011年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

便宜上の換算

2012年3月31日現在及び同日をもって終了した連結会計年度の連結財務諸表は、読者の便宜のために米国ドルに換算されている。私どもの監査は、日本円で表示されている金額の米国ドルへの換算の検証も含んでおり、私どもは、当該換算が連結財務諸表注記1に記載された方法に準拠しているものと認める。

(KPMG AZSA LLC)

2012年6月22日

日本、東京

東京エレクトロングループ

2012年3月31日現在において、東京エレクトロングループは、東京エレクトロン株式会社とその子会社30社で構成されています。

会社名	主な事業内容
国内	
連結子会社	
東京エレクトロン山梨株式会社	製造・開発
東京エレクトロン九州株式会社	製造・開発
東京エレクトロン東北株式会社	製造・開発
東京エレクトロン宮城株式会社	製造・開発
東京エレクトロンTS株式会社	製造・開発
東京エレクトロン技術研究所株式会社	製造・開発
東京エレクトロンソフトウェア・テクノロジーズ株式会社	開発
東京エレクトロンPV株式会社	開発
東京エレクトロンFE株式会社	フィールドソリューション
東京エレクトロンデバイス株式会社	販売
東京エレクトロンBP株式会社	物流・リース・施設管理等
東京エレクトロンエージェンシー株式会社	損害保険代理業務
パネトロン株式会社	販売
米国	
連結子会社	
Tokyo Electron U.S. Holdings, Inc.	持株会社
Tokyo Electron America, Inc.	販売・保守サービス
Timbre Technologies, Inc.	開発
TEL Technology Center, America, LLC	開発
TEL Epion Inc.	開発
TEL Venture Capital, Inc.	新技術の発掘、評価

会社名	主な事業内容
欧州	
連結子会社	
Tokyo Electron Europe Limited	販売・保守サービス
Tokyo Electron Israel Limited	保守サービス
アジア	
連結子会社	
Tokyo Electron Korea Limited	販売・保守サービス
Tokyo Electron Korea Solution Limited	フィールドソリューション
Tokyo Electron Taiwan Limited	販売・保守サービス
Tokyo Electron (Kunshan) Limited	製造
Tokyo Electron (Shanghai) Limited	販売・保守サービス
Tokyo Electron (Shanghai) Logistic Center Limited	物流
Tokyo Electron Device Asia Pacific Limited	販売
Tokyo Electron Device Singapore Pte. Ltd.	販売
Tokyo Electron India Private Limited	販売・保守サービス

株式情報

(2012年3月31日現在)

社名:

東京エレクトロン株式会社
〒107-6325
東京都港区赤坂五丁目3番1号
赤坂Bizタワー

設立:

1963年11月11日

定時株主総会:

6月

株式の状況:

一単元の株式数	100株
発行可能株式総数	300,000,000株
発行済株式の総数	180,610,911株
株主数	42,414名

上場証券取引所:

東京証券取引所第一部 (#8035)

会計監査人:

有限責任 あずさ監査法人

株主名簿管理人:

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社
(郵便物送付先・電話紹介先)
〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社証券代行部
☎0120-782-031 (フリーダイヤル)

お問合せ先:

東京エレクトロン株式会社 IR室
〒107-6325
東京都港区赤坂五丁目3番1号
赤坂Bizタワー
電話: 03-5561-7000

URL:

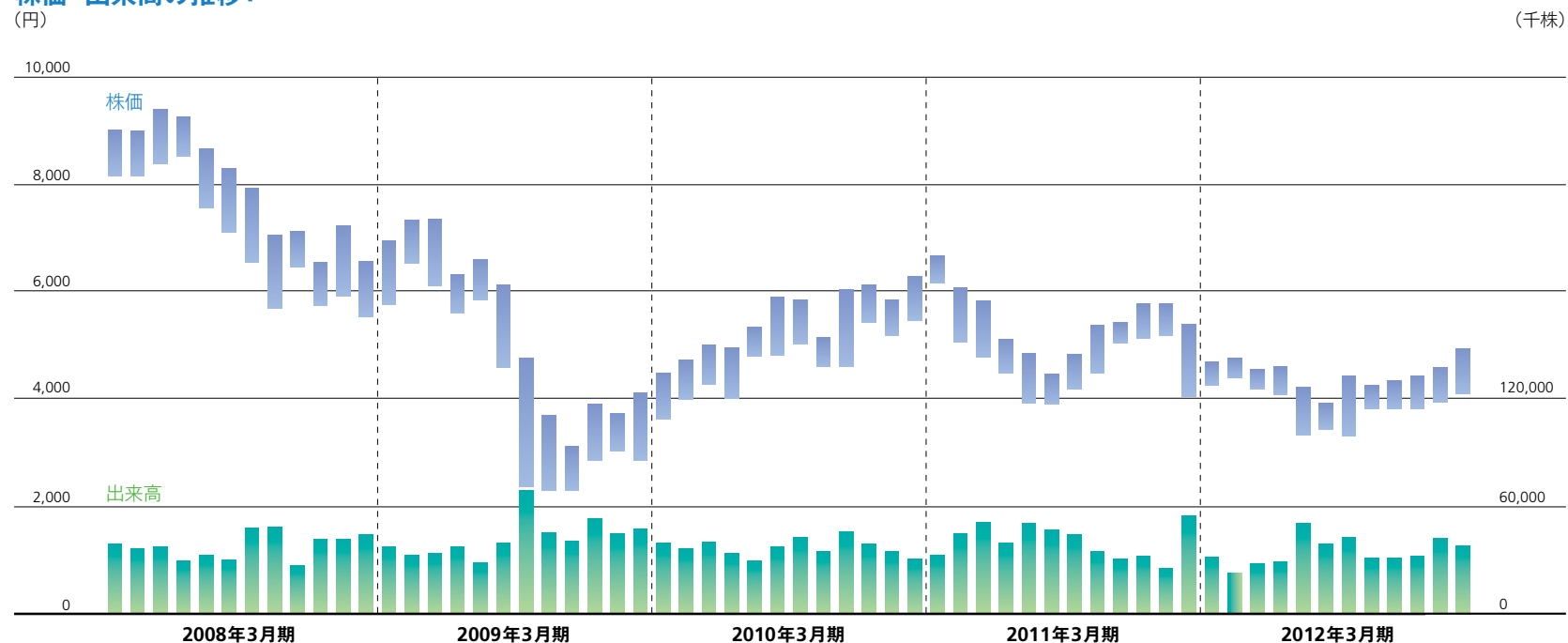
<http://www.tel.co.jp>

大株主の状況:

	所有株式数 (千株)	発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合 (%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	19,501	10.88
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	15,183	8.47
株式会社東京放送ホールディングス	7,727	4.31
SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT-TREATY CLIENTS	4,262	2.37
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505225	4,175	2.33
メロン バンク エヌエー アズ エージェント フォー イッツ クライアント メロン オムニバス ユーエス ペンション	3,849	2.14
ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン エス エル オムニバス アカウント	2,948	1.64
JPモルガン証券株式会社	2,908	1.62
資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口)	2,714	1.51
メロン バンク トリーティー クライアント オムニバス	2,366	1.32

所有株式数:千株未満を切り捨てて表示しています。
発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、自己株式(1,446,079株)を控除して算出しています。

株価・出来高の推移:



所有者別状況:

